

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ к журналу «Физика и техника полупроводников»

Том 27, 1993 год

	Стр.
1. Обзоры	2101
2. Структура, механические и термические свойства полупроводников (PACS 60)	2101
2.1. Структура полупроводников, кристаллография (PACS 61)	2101
2.1.1. Аморфные, стеклообразные полупроводники (PACS 61.40)	2101
2.1.2. Дефекты в полупроводниках (PACS 61.70)	2102
2.1.3. Ионная имплантация (PACS 61.70)	2103
2.1.4. Радиационные дефекты (PACS 61.80)	2103
2.2. Диффузия (PACS 66)	2104
2.3. Структура поверхности, границ раздела, тонких пленок (PACS 68)	2105
3. Электронная структура, электрические, магнитные и оптические свойства полупроводников (PACS 70)	2105
3.1. Электронные состояния (PACS 71)	2106
3.1.1. Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55)	2106
3.2. Транспортные явления (PACS 72)	2108
3.2.1. Генерация, рекомбинация, время жизни носителей заряда (PACS 72.20.N)	2109
3.2.2. Фотопроводимость и фотовольтаический эффект (PACS 72.40)	2109
3.3. Электронная структура и электрические свойства поверхности, границ раздела и тонких пленок (PACS 73)	2110
3.3.1. Электронные состояния на поверхности, границах раздела и в системах с пониженной размерностью (PACS 73.20)	2110
3.3.2. Контактные явления (PACS 73.30; 73.40)	2111
3.3.3. Электронные транспортные явления в тонких пленках и в системах с пониженной размерностью (PACS 73.50)	2113
3.4. Магнитные свойства полупроводников, магнитные резонансы (PACS 75; 76)	2113
3.5. Оптические свойства полупроводников. Взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78)	2114
3.5.1. Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20)	2114
3.5.2. Комбинационное рассеяние (PACS 78.30)	2115
3.5.3. Фотолуминесценция, излучательная рекомбинация (PACS 78.55; 78.60)	2115
3.5.4. Оптические свойства поверхности, границ раздела, тонких пленок (PACS 78.65)	2117
3.6. Эмиссия электронов и ионов. Ударная ионизация. Туннелирование (PACS 79)	2117
4. Получение и применение полупроводников (PACS 80)	2118
4.1. Методы получения, термообработка и травление полупроводников (PACS 81)	2118
4.2. Применение полупроводников, полупроводниковые приборы (PACS 85)	2119
4.3. Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55)	2120
5. Персоналии	2120
6. Информация о новых книгах	2120

- Фуллерен. Строение, динамика кристаллической решетки, электронная структура и свойства (обзор). Козырев С. В., Роткин В. В. 9, 1409
- Электронная структура примесей редкоземельных элементов в соединениях $A^{III}B^V$ (обзор). Мастеров В. Ф. 9, 1435
2. Структура, механические и термические свойства полупроводников (PACS 60)
- Спектр возбуждений разупорядоченного кристалла $A_xA_{1-x}B$ с концентрацией, изотопической примесью, близкой к порогу протекания. Корженевский А. Л. 5, 889
- Оценка температуры структурного превращения при нагреве монокристаллов на основе статистической теории растворов и метода псевдопотенциала. Глазов В. М., Кольцов В. Б., Куцова В. З., Ригель А. Р., Сиротюк С. В., Таран Ю. Н., Фалькевич Э. С. 7, 1080
- Фуллерен. Строение, динамика кристаллической решетки, электронная структура и свойства (обзор). Козырев С. В., Роткин В. В. 9, 1409

2.1. Структура полупроводников, кристаллография (PACS 61)

- Образование периодических структур с модулированным составом при когерентном разделении фаз в четверных твердых растворах полупроводников $A^{III}B^{IV}$. Ипатов И. П., Малышкин В. Г., Маслов А. Ю., Шукин В. А. 2, 285
- Масштаб флуктуаций состава в сплавах $Ge_{1-x}Si_x$. Шаховцова С. И., Шаховцов К. В., Шпинар Л. И., Ясковец И. И. 6, 1035
- Визуализация электрических неоднородностей в полупроводнике арсениде галлия. Лебедева Н. Н., Орбух В. И., Зейналлы А. Х. 7, 1134
- Полупроводники II—IV—V₂. Кесаманлы Ф. П., Рудь Ю. В. 11/12, 1761
- Двумерно-периодическая доменная структура сегнетоэлектрического включения в матрице. Ипатов И. П., Прошина О. В., Шукин В. А. 11/12, 1873
- Развитие неоднородностей состава при последнем росте эпитаксиальной пленки твердого раствора полупроводников $A^{III}B^V$. Малышкин В. Г., Шукин В. А. 11/12, 1932

2.1.1. Аморфные, стеклообразные полупроводники (PACS 61.40)

- Морфология, плотность состояний и поляризация в неоднородных слоях α -Si: H. Сулеман Х., Лигачев В. А., Филиков В. А. 2, 338
- Плотность электронных состояний «собственного» аморфного гидрированного кремния. Г о-

- ликова О. А., Икрамов Р. Г., Казанин М. М., Мездрогина М. М. 3, 465
- Влияние нейтронного облучения на инфракрасное поглощение в стеклообразном трисульфиде мышьяка. Конорова Л. Ф., Жданович Н. С. 3, 470
- Фотоиндуцированные дефекты в псевдолегированном α -Si: H. Голикова О. А., Икрамов Р. Г., Казанин М. М., Мездрогина М. М. 3, 474
- «Вспышечная» кинетика радиационного заряжения в неупорядоченных диэлектриках. Архипов В. И., Перова И. А. 4, 682
- Дисперсионный перенос в неупорядоченных органических полупроводниках. Плехин А. В. 4, 688
- Комбинационное рассеяние и люминесценция пористого кремния. Решина И. И., Гук Е. Г. 5, 728
- Эффект Холла в сплавах полупроводников с вырожденным электронным газом и его взаимосвязь с электропроводностью и магнитной восприимчивостью. Глазов В. М., Кольцов В. Б. 5, 769
- О механизме возникновения отрицательного дифференциального сопротивления в тонких пленках аморфного селена. Чеснис А. А. 5, 848
- Физические свойства и фотолюминесценция пористого кремния. Бреслер М. С., Яснеевич И. Н. 5, 871
- Поверхностные свойства пленок α -Si: H. Данишевский А. М., Латинский В., Коньков О. И., Теруков Е. И., Мездрогина М. М., Чусовитин М. С. 6, 913
- Влияние примесей галогенов на перенос носителей заряда в стеклообразных полупроводниках системы Se—As. Казакова Л. П., Лебедев Э. А., Исаев А. И., Мехтиева С. И., Захарова Н. Б., Ятлинко И. И. 6, 959
- Последеградационные характеристики p - i - n фотоэлементов из гидрированного аморфного кремния (α -Si: H). Аронов Д. А., Кабулов Р. Р., Маматкулов Р., Усманов Ш., Юбаев Ю. М. 6, 1014
- Оценка температуры структурного превращения при нагреве монокристаллов кремния на основе статистической теории растворов и метода псевдопотенциала. Глазов В. М., Кольцов В. Б., Куцова В. З., Ригель А. Р., Сиротюк С. В., Таран Ю. Н., Фалькевич Э. С. 7, 1080
- Исследование влияния освещения на свойства парамагнитных дефектов в пленках аморфного гидрогенизированного карбида кремния переменного состава. Карягин С. Н., Константинова Е. А., Лупачева А. Н. 7, 1227
- Морфология, проводимость и эффект псевдолегирования в аморфных и аморфнокристаллических пленках C: H. Данченков А. А., Лигачев В. А., Попов А. И. 8, 1233
- Влияние концентрации азота на микроструктуру и темновую проводимость пленок α -Si_{1-x}N_x: H. Будагян Б. Г., Айвазов А. А., Сазонов А. Ю. 8, 1365

- Светочувствительные структуры Шоттки на пористом кремнии. Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Сресели О. М., Ярощцкий И. Д. 8, 1371
- Глубокие состояния в твердых растворах $Pb_{1-x}Sn_xTe$, легированных галлием. Выграненко Ю. К., Слынько В. В., Слынько Е. И. 8, 1387
- Аморфный гидрированный кремний, легированный диспрозом. Куликов Г. С., Мездрогина М. М., Першеев С. К., Абдурахманов К. П. 8, 1389
- Плотность дефектов в приповерхностной области слоев аморфного гидрированного кремния. Голикова О. А., Домашевская Э. П., Мавлянов Х. Ю., Терехов В. А., Тростянский С. Н. 9, 1468
- О влиянии электронного пучка на энергетическое распределение локализованных состояний в аморфном нитриде кремния. Терехов В. А., Селезнев В. Н., Домашевская Э. П. 9, 1577
- Влияние легирования на фотопроводимость $a-Si:H$. Казанский А. Г., Шамолина Е. А. 10, 1688
- Влияние уровня легирования и температуры на эффект Стеблера—Вронского в пленках $a-Si:H$, легированных фосфором. Казанский А. Г., Яркин Д. Г. 10, 1693
- О природе фотоиндуцированных дефектов в аморфном гидрированном кремнии. Звягин И. П., Курова И. А., Ормонт Н. Н. 10, 1707
- Эффективная электролюминесценция пористого кремния. Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Сресели О. М., Ярощцкий И. Д. 11/12, 1815
- Температурная зависимость стационарной фотолуминесценции пористого кремния в видимой области спектра. Лебедев А. А., Ременюк А. Д., Рудь Ю. В. 11/12, 1846
- Рекомбинация через комплексы оборванных связей в аморфном кремнии. Звягин И. П. 11/12, 1857
- Роль света в процессах формирования пористого кремния на подложках p -типа. Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Сресели О. М., Ярощцкий И. Д. 11/12, 1963
- 2.1.2. Дефекты в полупроводниках (PACS 61.70)
- Бистабильные комплексы дефектов с углеродной компонентой в кремнии. Мякенькая Г. С., Гуцев Г. Л. 1, 67
- Структурные дефекты и фотолуминесценция эпитаксиальных слоев $In_xGa_{1-x}As$. Семенова Г. Н., Кладько В. П., Крыштаб Т. Г., Садофьев Ю. Г., Свительский А. В., Корытцев С. В. 1, 162
- О механизме подавления генерации термоэлектронов в кремнии примесными атомами углерода. Мушин Л. И., Маркевич В. П. 2, 193
- Особенности явления самокомпенсации в пленках $PbSe$ (Тl, Pb_{ex}). Гаврикова Т. А., Зыков В. А., Немов С. А. 2, 200
- Реакция разрушения комплексов дефектов с образованием A -центров в кремнии. Мякенькая Г. С., Гуцев Г. Л. 3, 391
- Свойства эпитаксиального арсенида индия, легированного редкоземельными элементами. Баранов А. Н., Воронина Т. И., Лагунова Т. С., Сиповская М. А., Шерстнев В. В., Яковлев Ю. П. 3, 421
- Влияние процесса газофазной эпитаксии на скопления электрически активных дефектов в подложках из GaAs (Cr). Калинушкин В. П., Юрьев В. А., Мушин Д. И., Плоппа М. Г., Тимо Т. В. 3, 538
- Процессы формирования «новых доноров» при термобработке кремния с различной концентрацией кислорода. Андреев Б. А., Голубев В. Г., Емцев В. В., Кропотов В. Г. И., Оганесян Г. А., Шмальц К. 4, 567
- Аннигиляция пар Френкеля в полупроводниках. Емцев В. В., Машовец Т. В., Михнович В. В. 4, 708
- Примесь алюминия в кремниевых полупроводниковых структурах SiO_2-Si . Дутов А. Г., Комар В. А., Ширяев С. В. 6, 1001
- Легирование эпитаксиальных слоев GaAs акцепторной примесью Zn при жидкофазной эпитаксии из растворов-расплавов Ga—Bi. Туат Ле, Новиков С. В., Савельев И. Г., Шелковников Д. Н., Шмарцев Ю. В. 6, 1007
- Исследование чувствительности к водороду структуры ZnSe/GaAs. Мекекечко А. Ю., Коваленко А. В., Черненко И. М., Катков В. Ф. 6, 1060
- К вопросу о радиационном дефектообразовании в нейтронно-легированном кремнии. Юнусов М. С., Каримов М., Оксенгендлер Б. Л., Хакимов М. 7, 1130
- Локальное геттерирование железа слоем металла, напыленного на поверхность кремния. Абдурахманов К. П., Далиев Х. С., Куликов Г. С., Лебедев А. А., Утамуррадова Ш. Б., Юсупова Ш. А. 7, 1222
- Морфология, проводимость и эффект псевдолегирования в аморфных и аморфно-кристаллических пленках C:H. Данченко А. А., Лигачев В. А., Попов А. И. 8, 1233
- Релаксация решетчи при фотоионизации глубоких примесей различной природы. Рыскин А. И., Лангер Ежи М. 8, 1369
- Диффузионное легирование серебром аморфного гидрированного кремния с примесью бора. Куликов Г. С., Мездрогина М. М., Першеев С. К. 8, 1392
- Образование двойных термоэлектронов в $Cz-Si$ с различной концентрацией кислорода. Емцев В. В., Машовец Т. В., Оганесян Г. А., Шмальц К. 9, 1545

- ригическая концентрация кислорода в Cz—Si и кластеризация примесных атомов при термообработке. Емцев В. В., Оганесян Г. А., Шмальц К. 9, 1549
- Дистория сложного дефекта со слабой связью. Гавричков В. А. 10, 1667
- О природе фотоиндуцированных дефектов в аморфном гидрированном кремнии. Звягин И. П., Курова И. А., Ормонт Н. Н. 10, 1707
- Константы деформационного потенциала глубоких акцепторов в модели короткодействующего потенциала центра. Костин И. В., Осипов Е. Б., Осипова Н. А. 10, 1743
- Перколяция тока в полимерно-полупроводниковой структуре. Фистуль В. И. 11/12, 1788
- Самокомпенсация в области собственной проводимости CdTe (С1) в условиях двухфазного равновесия системы кристалл—газ. Матвеев О. А., Терентьев А. И. 11/12, 1894
- «Новые доноры» в термообработанном кремнии с изoeлектронной примесью германия. Емцев В. В., Оганесян Г. А., Шмальц К. 11/12, 2024
- Роль кислорода в нестабильности углеродосодержащих радиационных дефектов в кремнии. Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. Б., Ли З., Шмидт Б. 11/12, 2071
- 2.1.3. *Ионная имплантация* (PACS 61.70)
- Исследование методом DLTS дефектов, образующихся в кремнии при высокотемпературном облучении ионами N⁺. Антонова И. В., Шаймеев С. С., Тыщенко И. Е. 2, 234
- Влияние примесей переходных металлов на накопление радиационных дефектов в p-кремнии. Казакевич Л. А., Кузнецов В. И., Лугаков П. Ф., Салманов А. Р. 3, 478
- Влияние постимплантационного отжига на электрофизические свойства слоев кремния, имплантированного фтором. Омеляновская Н. М., Краснобаев Л. Я., Федоров В. В. 4, 554
- Радиационное распухание и распыление Cd_xHg_{1-x}Te при имплантации ионов в больших дозах. Ибрагимова М. И., Петухов В. Ю., Хайбуллин И. Б. 4, 560
- Послойное исследование ионно-имплантированного кремния методами эллипсометрии и избирательного самочивания. Бахтурова Л. Ф., Бакоев В. В., Долговесова И. П., Аюпов Б. М. 4, 588
- Явление самовосстановления структуры имплантируемых полупроводников. Жуковский П. В. 5, 789
- Процессы отжига и перестройки радиационных дефектов в кремнии, имплантированном высокоэнергетическими ионами бора. Аль-Баккур Ф., Дидык А. Ю., Козлов И. П., Оджаев В. Б., Петров В. В., Просолович В. С., Сохацкий А. С., Янковский О. Н. 5, 829
- К вопросу о радиационном дефектообразовании в нейтронно-легированном кремнии. Юнусов М. С., Каримов М., Оксенгендлер Б. Л., Хакимов М. 7, 1130
- Поведение бора и азота в приповерхностном слое кремния при синтезе захороненных слоев имплантацией ионов N⁺. Качурин Г. А., Тыщенко И. Е. 7, 1194
- Трансформация кристаллической структуры Cd_xHg_{1-x}Te при ионной имплантации Ибрагимова М. И., Файзрахманов И. А., Хайбуллин И. Б., Саинов Н. А. 8, 1276
- Влияние нитридации на радиационное изменение электрофизических свойств МДП структур на основе кремния. Кучинский П. В., Ломако В. М., Петрунин А. П., Патракеев С. П., Суриков И. Н., Шахлевич Л. Н. 8, 1354
- Ионная имплантация донорной примеси в фосфиде индия. Галина Т. М., Володько В. Г., Демидов Е. С., Подчищаева О. В. 8, 1379
- Энергетический спектр вакансий халькогена в ионно-имплантированном сульфиде свинца. Вейс А. Н. 8, 1384
- О влиянии нейтронного облучения на генерацию термодоноров и преципитацию кислорода в кремнии при 650 °С. Нейман В. Б., Помозов Ю. В., Шаховцов В. И., Кабалдин А. Н., Цмоць В. М. 10, 1651
- Эффективность образования радиационных дефектов в p-кремнии, выращенном с использованием магнитного поля. Казакевич Л. А., Колховский И. И., Кузнецов В. И., Лугаков П. Ф., Салманов А. Р. 10, 1680
- Радиационные дефекты в кремнии, облученном α-частицами при низкой температуре. Берман Л. С., Иванов А. М., Павлова М. Л., Ременюк А. Д., Строкан Н. Б. 11/12, 1795
- 2.1.4. *Радиационные дефекты* (PACS 61.80)
- Краевое излучение ZnSe (Li), облученном электронами. Гринев В. И. 1, 124
- Изменение диаграммы рассеяния света монокристаллами нелегированного GaAs вследствие электронного облучения. Калинушкин В. П., Юрьев В. А. 1, 188
- Особенности генерационного тока в облученных α-частицами p⁺—n-переходах из высокоомного кремния. Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. Б. 2, 205
- Влияние лазерного облучения на физические свойства высокоомных кристаллов ZnSe. Артамонов В. В., Байдуллаева А., Беляев С. В., Власенко А. И., Гнатюк В. А., Мозоль П. Е. 2, 228
- Глубокие ловушки в n-GaAs, облученном быстрыми нейтронами. Брудный В. Н., Колин Н. Г., Потапов А. И. 2, 260

- Профили изотопов, образованных в полупроводниках соединениях $A^{III}B^V$ при облучении высокоэнергетичными α -частицами. Дидик В. А., Козловский В. В., Малкович Р. Ш., Скорятин Е. А. 2, 265
- Профили изотопов, созданных в арсениде галлия под действием α -частиц с энергией 12, 16 и 20 МэВ. Дидик В. А., Козловский В. В., Малкович Р. Ш., Скорятин Е. А. 2, 343
- Компенсация проводимости n -GaAs (Yb) радиационными дефектами. Козловский В. В., Захаренков Л. Ф. 2, 345
- Влияние нейтронного облучения на инфракрасное поглощение в стеклообразном трисульфиде мышьяка. Конорова Л. Ф., Жданович Н. С. 3, 470
- Влияние примесей переходных металлов на накопление радиационных дефектов в p -кремнии. Казакевич Л. А., Кузнецов В. И., Лугаков П. Ф., Салманов А. Р. 3, 478
- Преобразование системы дефектов вблизи поверхности кристаллов $CdTe$, $Zn_xCd_{1-x}Te$, $CdTe_{1-x}Se_x$, обработанных ионами аргона. Бабенцов В. Н., Бекетов Г. В., Горбань С. И. 3, 504
- Особенности образования и отжига радиационных дефектов в n -кремнии, легированном цирконием. Казакевич Л. А., Кузнецов В. И., Лугаков П. Ф., Салманов А. Р., Прокофьева В. К. 3, 535
- Влияние радиационного облучения на люминесценцию кристаллов CdP_2 . Федотов В. Г., Гатальский Г. В., Трухан В. М. 4, 551
- О природе индуцируемых радиационно-термическим воздействием центров люминесценции в p -GaAs (Zn). Винник Е. В., Глинчук К. Д., Гуровшев В. И., Прохорович А. В. 4, 610
- Распределение концентрации ртути при импульсном лазерном отжиге $Cd_xHg_{1-x}Te$. Валь А., Кузьма М., Поццак М., Шерегий Е. М. 4, 622
- Явление самовосстановления структуры имплантируемых полупроводников. Жуковский П. В. 5, 789
- Влияние нейтронного облучения на перемещение границы p - n -перехода в светодиодах на основе GaAs (Zn). Сукач Г. А. 5, 838
- О механизме радиационно-стимулированных изменений положения максимума полос «примесной» люминесценции в арсениде галлия и фосфиде индия. Винник Е. В., Глинчук К. Д., Гуровшев В. И., Прохорович А. В. 5, 841
- О причинах различия дозовых зависимостей интенсивности различных полос люминесценции в облученных быстрыми частицами полупроводниковых соединениях $A^{III}B^V$. Винник Е. В., Глинчук К. Д., Гуровшев В. И., Прохорович А. В. 6, 1030
- Радиационное воздействие дейтронов на приемники излучения из высокоомного кремния. Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. Б. 7, 1113
- Влияние термообработки на параметры границы раздела структур $Si-SiO_2$ после радиационных воздействий. Вовк О. В., Лелеченко В. П., Солошенко В. И., Ройзин Я. О., Чкунина В. Н. 8, 1349
- Влияние нитридации на радиационное изменение электрофизических свойств МДП структур на основе кремния. Кучуринский П. В., Ломако В. М., Петрунин А. П., Патракеев С. П., Суриков И. Н., Шахлевич Л. Н. 8, 1354
- О зависимости радиационной стойкости интенсивности люминесценции твердых растворов соединений $A^{III}B^V$ от их состава. Глинчук К. Д., Гуровшев В. И., Прохорович А. В. 8, 1395
- О влиянии нейтронного облучения на генерацию термодонов и преципитацию кислорода в кремнии при 650 °С. Неймаш В. Б., Помозов Ю. В., Шаховцов В. И., Кабалдин А. Н., Цмоць В. М. 10, 1651
- Эффективность образования радиационных дефектов в p -кремнии, выращенном с использованием магнитного поля. Казакевич Л. А., Колковский И. И., Кузнецов В. И., Лугаков П. Ф., Салманов А. Р. 10, 1680
- Образование дефектов в кремнии в диапазоне температур 10—30 К при электронном облучении. Жалко-Титаренко И. В., Крайчинский А. Н., Осташко Н. И., Рогуцкий И. С. 10, 1698
- Радиационные дефекты в кремнии, облученном α -частицами при низкой температуре. Берман Л. С., Иванов А. М., Павлова М. Л., Ременюк А. Д., Строкан Н. Б. 11/12, 1795
- Влияние особенности структуры эпитаксиальных слоев $Cd_xHg_{1-x}Te$ на электрические и фотоэлектрические свойства при лазерном облучении. Мозоль П. Е., Гнатюк В. А., Сукач А. В., Власенко А. И., Копишинская Е. П., Лукьяненко В. И. 11/12, 1820
- Исследование кинетики нейтронного легирования германия: характеристика материала и определение ядерно-физических постоянных. Забродский А. Г., Алексеенко М. В. 11/12, 2033
- Прецизионная полупроводниковая спектроскопия ионов. Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Маляренко А. М., Строкан Н. Б., Суханов В. Л., Шмидт Б., Борани И. 11/12, 2055
- Роль кислорода в нестабильности углеродосодержащих радиационных дефектов в кремнии. Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. Б., Ли З., Шмидт Б. 11/12, 2071

2.2. Диффузия (PACS 66)

Суперионные свойства полупроводника $Cu_{2-x}Se$ как проявления экситонной фазы с переносом заряда. Федорин В. А. 3, 354

- Диффузия лития в p -ZnSe. Краснов А. Н., Ваксман Ю. Ф., Пуртов Ю. Н. 3, 511
- Влияние подвижных дефектов на характеристики контакта металл—полупроводник в кристаллах CdS. Дроздова И. А., Ембергенов Б., Корсунская Н. Е., Маркевич И. В. 4, 674
- Диффузия компонентов и примесей в кластеризующихся твердых растворах. Сафонов Л. Н. 8, 1286
- Диффузионное легирование серебром аморфного гидрированного кремния с примесью бора. Куликов Г. С., Мездрогина М. М., Переев С. К. 8, 1392
- Влияние галлия на спектры низкотемпературной фотолюминесценции теллурида кадмия при диффузионном легировании. Бабенцов В. Н., Власенко А. И., Сочинский Н. В., Тарбаев Н. И. 10, 1599
- 2.3. Структура поверхности, границ раздела, тонких пленок (PACS 68)
- (AlGaAs/GaAs) — фотоприемники на подложках Si, полученные комбинированным методом жидкофазной и молекулярно-пучковой эпитаксии. Андреев В. М., Антипов В. Г., Калиновский В. С., Каллион Р. В., Никишин С. А., Рувимов С. С., Степанов М. В., Танклевская Е. М., Хвостиков В. П. 1, 141
- Рентгенодифракционное исследование границы раздела между кристаллами $Hg_{1-x}Cd_xTe$ и анодными пленками. Галкин И. М., Нефедов А. А., Чапланов В. А., Шипов И. А., Якимов С. С. 2, 239
- Влияние структурной неоднородности полупроводника и диэлектрика на зарядовые свойства поверхности МДП структур. Муминов Р. А., Малаева В. Т., Оксман М. М., Ишмуратов Г. В. 2, 250
- Фоточувствительность поверхности-барьерных структур на основе InP с микрорельефной границей раздела. Басюк Е. В., Дмитрук Н. Л., Маева О. И. 3, 415
- Квантовохимическое моделирование взаимодействия фтора с поверхностью (111) кремния. Гадияк Г. В., Мороков Ю. Н. 5, 736
- Нелинейные поверхностные акустические волны в сверхрешетках GaAs—AlAs. Адамшвили Г. Т., Пейкришвили М. Д., Бицадзе Д. Д. 5, 832
- Поверхностные свойства пленок α -Si : H. Данишевский А. М., Латинис В., Конькова О. И., Теруков Е. И., Мездрогина М. М., Чусовитин М. С. 6, 913
- Поведение бора и азота в приповерхностном слое кремния при синтезе захороненных слоев имплантацией ионов N^+ . Качурин Г. А., Тысченко И. Е. 7, 1194
- Локальное легирование железа слоем металла, напыленного на поверхность кремния. Абдурахманов К. П., Далиев Х. С., Куликов Г. С., Лебедев А. А., Утамурадова Ш. Б., Юсупов Ш. А. 7, 1222
- Влияние термообработки на параметры границы раздела структур Si—SiO₂ после радиационных воздействий. Вовк О. В., Лелеченко В. П., Солошенко В. И., Ройзин Я. О., Чукина В. Н. 8, 1349
- Визуализация поверхности (111) кремниевых шайб p -типа в атмосферных условиях с помощью сканирующего туннельного микроскопа. Болотов Л. Н., Козлов В. А., Макаренко И. В., Титков А. Н. 8, 1375
- Плотность дефектов в приповерхностной области слоев аморфного гидрированного кремния. Голикова О. А., Домашевская Э. П., Мавлянов Х. Ю., Терехов В. А., Тростянский С. Н. 9, 1468
- О возможности получения изопериодических с подложкой InP слоев $In_{0.52}Al_{0.48}As$ методом жидкофазной эпитаксии при низких температурах ($\sim 650^\circ C$). Бер Б. Я., Быстров С. Б., Зушинский Д. А., Корнякова О. В., Гуан Ле, Новиков С. В., Савельев И. Г., Третьяков В. В., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. 9, 1480
- Исследование распределения примеси в области гетерограницы p -GaInAsSb / p -GaAlAsSb. Богословская А. Б., Колчанова Н. М., Манягин Ф. И., Попов А. А., Сукач Г. А. 9, 1574
- Гетерозитаксимальная пассивация поверхности GaAs. Карпович И. А., Бедный Б. И., Байдус Н. В., Батукова Л. М., Звонков Б. Н., Степихова М. В. 10, 1736
- Эллипсометрическое исследование анодного окисла на твердых растворах $Ga_{1-x}Al_xAs$. Макарова Т. Л., Шаронова Л. В., Шмарцев Ю. В. 11/12, 1830
- Кинетика образования структурных дефектов в поверхностном слое кремния при термическом окислении. Шаповалов В. П., Грядун В. И., Токарев В. П. 11/12, 1851
- Сверхрешетки PbS—CdS, полученные лазерным испарением в вакууме. Бакуева Л. Г., Ильин В. И., Мусихин С. Ф., Рабизо О. В., Шаронова Л. В., Гирич А. В. 11/12, 1866
- Алмазоподобные пленки, полученные лазерным напылением, и многослойные структуры на их основе. Бакуева Л. Г., Ильин В. И., Мусихин С. Ф., Шаронова Л. В. 11/12, 1868
- Scattering of Surface Acoustic Waves and Heat Transfer through the Nonuniform Interface. Fishman L. M. 11/12, 1918
- Влияние поверхностного потенциала на образование поверхностного фотографического изображения в AgBr. Горлин Г. Б., Туланов В. Т. 11/12, 1967
3. Электронная структура, электрические, магнитные и оптические свойства полупроводников (PACS 70)
- Получение и свойства поликристаллических твердых растворов SiC—AlN. Сафаралиев Г. К., Таиров Ю. М., Цветков

- В. Ф., Шабанов Ш. Ш., Пащук Е. Г. 3, 402
- Фуллерен. Строение, динамика кристаллической решетки, электронная структура и свойства (обзор). Козырев С. В., Роткин В. В. 9, 1409
- Полупроводники II—IV—V₂. Кесаманлы Ф. П., Рудь Ю. В. 11/12, 1761
- ### 3.1. Электронные состояния (PACS 71)
- Особенности явления самокомпенсации в пленках PbSe (Pb, Pb_{ex}). Гаврикова Т. А., Зыков В. А., Немов С. А. 2, 200
- Морфология, плотность состояний и поляризации в неоднородных слоях α -Si: Н. Сулеман Х., Лигачев В. А., Филиков В. А. 2, 338
- Хвосты плотности состояний в твердых растворах Zn_xCd_{1-x}Hg_{1-y}Te. Андрухив А. М., Гадаев О. А., Иванов-Омский В. И., Цидильковский Э. И. 2, 348
- Метод расчета энергии связи изовалентных и изоэлектронных примесей в тетраэдрических полупроводниках. Волков Д. А., Фистуль В. И. 3, 431
- Параметры зонного спектра, электрофизические и магнитные свойства четверных полуметаллических полупроводников HgCdMnTe. Гавалешко Н. Н., Тетеркин В. В., Сизов Ф. Ф., Паранчич С. Ю. 3, 459
- Плотность электронных состояний «собственного» аморфного гидрированного кремния. Голикова О. А., Икрамов Р. Г., Казанин М. М., Мездрогина М. М. 3, 465
- Феноменологический анализ граничных условий для волновой функции модели Кейна. Кисин М. В. 3, 488
- Взаимодействие дрейфующих электронов с оптическими фононами. Пожела Ю., Пожела К. 3, 497
- Индукцируемые током добавки к эффективной диэлектрической проницаемости неоднородных полупроводниковых сплавов. Васьюк Ф. Т., Солдатенко Ю. Н. 4, 695
- Энергетический спектр PbTe (Zn⁺) по данным оптического поглощения. Вейс А. Н., Рыданов А. Ю., Суворова Н. А. 4, 701
- Теория протекания и переход Мотта в легированных полупроводниках. Кязымзаде А. Г. 4, 717
- Люминесценция поляритонов вблизи поверхности в арсениде галлия. Бойко С. И., Горбань И. С., Крохмаль А. П., Осинский В. И., Рожко И. А. 5, 815
- Анионы в ограниченной одномерной геометрии. Гефен Ювал., Энтин-Вольман Ора. 5, 859
- Флуктуационные состояния в полупроводниковых твердых растворах с вырожденными зонами. Карпов В. Г., Субашиев А. В. 5, 884
- Осцилляции магнитосопротивления в напряженных сверхрешетках Ge/Ge_{1-x}Si_x в наклонном магнитном поле. Арапов Ю. Г., Городилов Н. А., Кузнецов О. А., Неверов В. Н., Орлов Л. К., Рубцова Р. А., Харус Г. И., Чернов А. Л., Шелушина Н. Г., Штрапенин Г. Л. 7, 1165
- Фотостимулированные осцилляции экранированного вырожденным электронным газом кулоновского поля. Шмелев Г. М., Железняк А. Т. 7, 1224
- Морфология, проводимость и эффект псевдолегирования в аморфных и аморфно-кристаллических пленках С: Н. Данченков А. А., Лигачев В. А., Попов А. И. 8, 1233
- Кулоновское взаимодействие носителей в тонких полупроводниковых нитях. Андрушин Е. А., Силин А. П. 8, 1256
- Использование кластерного приближения для исследования легированного кристалла кремния. Оношко Д. Е., Рыскин А. И. 8, 1361
- О влиянии электронного пучка на энергетическое распределение локализованных состояний в аморфном нитриде кремния. Терехов В. А., Селезнев В. Н., Домашевская Э. П. 9, 1577
- Исследование незаполненных электронных состояний и определение сродства к электрону PbS (100) с помощью спектроскопии обратной фотомиссии. Артамонов О. М., Дмитриева О. Г., Самарин С. Н., Яковлев И. И. 10, 1730
- Константы деформационного потенциала глубоких акцепторов в модели короткодействующего потенциала центра. Костин И. В., Осипов Е. Б., Осипова Н. А. 10, 1743
- Исследование структуры зоны проводимости в твердом растворе InAsSbP. Воронина Т. И., Лагунова Т. С., Моисеев К. Д., Сиповская М. А., Тимченко И. Н., Яковлев Ю. П. 11/12, 1777
- #### 3.1.1. Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55)
- Бистабильные комплексы дефектов с углеродной компонентой в кремнии. Мякенькая Г. С., Гуцев Г. Л. 1, 67
- Особенности генерационного тока в облученных α -частицами $p^+ - l$ -переходах из высокоомного кремния. Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. Б. 2, 205
- Исследование методом DLTS дефектов, образующихся в кремнии при высокотемпературном облучении ионами N⁺. Антонова И. В., Шаймеев С. С., Тыщенко И. Е. 2, 234
- Глубокие ловушки в *n*-GaAs, облученном быстрыми нейтронами. Брудный В. Н., Колин Н. Г., Потапов А. И. 2, 260
- Влияние легирования галлием на свойства твердых растворов Pb_{1-x}Ge_xTe. Акимов Б. А., Албул А. В., Иванчик И. И., Рябова Л. И., Слынько Е. И., Хохлов Д. Р. 2, 351

- Метод расчета энергии связи изовалентных и изоэлектронных примесей в тетраэдрических полупроводниках. Волков Д. А., Фистуль В. И. 3, 431
- Влияние границы раздела на захват и эмиссию носителей глубокими центрами. Пахомов А. А., Ясиевич И. Н. 3, 482
- Особенности поведения глубоких центров в особо чистом германии. Глориозова Р. И., Колесник Л. И. 4, 545
- Фотовозбуждение мелких акцепторов в $Cd_xHg_{1-x}Te$. Цыпишка Д. И., Иванов-Омский В. И., Георгиев Е. И., Гуцуляк Л. М., Миронов К. Е. 4, 714
- Фотоэлектрически активные и неактивные медленные центры прилипания электронов в кристаллах ZnSe. Ризаханов М. А., Хамидов М. М. 5, 721
- Диагностика пленок арсенида галлия, выращенных методом атомно-слоевой эпитаксии. Кольченко Т. И., Коява В. Т., Ломако В. М. 5, 822
- Резонансы в температурной зависимости электропроводности легированного кремния, обусловленные возбужденными состояниями примеси. Ждан А. Г., Лифшиц Т. М., Рыльков В. В., Шафран А. Г. 5, 845
- Глубокие уровни и редукция проводимости прямой гетероструктуры с селективным легированием после подачи отпирающего импульса напряжения на затвор. Горев Н. Б., Макарова Т. В., Прохоров Е. Ф., Уколов А. Т., Эппель В. И. 6, 996
- Примесь алюминия в кремниевых полупроводниковых структурах SiO_2-Si . Дутов А. Г., Комар В. А., Ширяев С. В. 6, 1001
- Радиационное воздействие дейтронов на приемники излучения из высокоомного кремния. Вербичкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. Б. 7, 1113
- Особенности температурной зависимости концентрации свободных носителей в полупроводнике, содержащая бистабильную U^- -примесь. Никитина А. Г., Зуев В. В. 7, 1211
- Исследование влияния освещения на свойства парамагнитных дефектов в пленках аморфного гидрогенизированного карбида кремния переменного состава. Карягин С. Н., Константинова Е. А., Лупачева А. Н. 7, 1227
- Идентификация многозарядных объемных уровней при релаксационной спектроскопии границы раздела полупроводник—диэлектрик. Дмитриев С. Г., Ждан А. Г., Маркин Ю. В. 8, 1247
- Обработка спектров релаксационной спектроскопии глубоких уровней методом математического моделирования. Шматов А. 8, 1282
- Фотоионизация иона Fe^{2+} в ZnS: релаксация решетки. Васильев А. В., Зингер Г. М., Розенфельд Ю. Б., Рыскин А. И. 8, 1305
- Исследование кластерного приближения для исследования легированного кристалла кремния. Оношко Д. Е., Рыскин А. И. 8, 1361
- Релаксация решетки при фотоионизации глубоких примесей различной природы. Рыскин А. И., Лангер Ежи М. 8, 1369
- Энергетический спектр вакансий халькогена в ионно-имплантированном сульфиде свинца. Вейс А. Н. 8, 1384
- Глубокие состояния в твердых растворах $Pb_{1-x}Sn_xTe$, легированных галлием. Выграненко Ю. К., Слынько В. В., Слынько Е. И. 8, 1387
- Влияние глубоких уровней на эффекты поля в гомогенных периодических полупроводниковых структурах на основе кремния. Владимирова Е. В., Гусятников В. Н., Журавлев К. А., Иванченко В. А., Павлов В. Г. 8, 1400
- Электронная структура примесей редкоземельных элементов в соединениях $A^{III}B^V$ (обзор). Мастеров В. Ф. 9, 1435
- О роли H_2^+ -комплексов в оптимизации n -InSb-смесителей миллиметрового диапазона волн. Гершензон Е. М., Грачев С. А., Литвак-Гоская Л. Б. 9, 1464
- Влияние легирования галлинием висмутового раствора-расплава на остаточные примеси в эпитаксиальном GaAs. Журавлев К. С., Якушева Н. А., Шамирзаев Т. С., Погадаев В. Г., Шегай О. А. 9, 1473
- Изотермическая и термостимулированная релаксация тока и емкости в слабо асимметричном $p-n$ -переходе с неоднородным профилем легирования n - и p -областей. Урманов Н. А., Степанова М. Н. 9, 1495
- Исследование комплекса $V_{Ga}Sn_{Ga}$ в GaAs методами поляризованной фотолуминесценции и пьезоспектроскопии. I. Строение комплекса и его переориентация при низких одноосных давлениях. Гуткин А. А., Решиков М. А., Сосновский В. Р. 9, 1516
- Исследование комплекса $V_{Ga}Sn_{Ga}$ в GaAs методами поляризованной фотолуминесценции и пьезоспектроскопии. II. Явление двухступенчатого выстраивания. Гуткин А. А., Решиков М. А., Сосновский В. Р. 9, 1526
- Аномальные (с двумя максимумами) пики в спектрах токовой спектроскопии в $p-n$ -структуре, связанные с одним типом глубоких состояний. Урманов Н. А., Гафурова М. В. 9, 1535
- Аннигиляция позитронов на примесях с глубокими уровнями в полупроводниках. Прокопьев Е. П. 9, 1569
- Влияние начального заполнения глубоких центров на положение пика термостимулированного тока в $n^+ - p$ -переходе с произвольным отношением концентрации мелких и глубоких центров. Урманов Н. А., Гафурова М. В. 9, 1572
- Особенности низкотемпературной проводимости германия, легированного ртутью. Банная В. Ф., Литвак-Горская Л. Б., Луговая Г. Я. 10, 1661
- Токовая релаксационная спектроскопия глубоких уровней (i -DLTS). Кузнецов Н. И. 10, 1674

Образование дефектов в кремнии в диапазоне температур 10—300 К при электронном облучении. Жалко-Титаренко И. В., Крайчинский А. Н., Осташко Н. И., Рогоцкий И. С. 10, 1698

Междоузельные состояния f -примесей в кремнии. Фистуль В. И., Шмугуров А. В. 11/12, 1910

3.2. Транспортные явления (PACS 72)

Переходы Андерсона в системе D^- -центров. Гинзбург Л. П. 1, 30

Акустоэлектрический эффект и термоэдс увеличения электронов фононами в режиме слабой локализации. Афонин В. В., Гальперин Ю. М. 1, 115

Свойства компенсированных пленок в системе сульфид свинца—сульфид кадмия. Зимин С. П., Корегина Е. Л., Бочкарева Л. В. 1, 185

Электрофизические свойства твердых растворов $Si_{1-x}Ge_x$, полученных методом жидкофазной эпитаксии. Саидов А. С., Лейдерман А. Ю., Сапаев Б., Каражанов С. Ж. 2, 256

Явления переноса в $Pb_{0.78}Sn_{0.22}Te$ с большим содержанием примеси In. Немов С. А., Равич Ю. И., Березин А. В., Гасулянец В. Э., Житинская М. К., Прошин В. И. 2, 299

Асимметрия перколяционной электропроводности компенсированного n -InP. Ашмон-тас С., Скучене А. 2, 307

Компенсация проводимости n -GaAs (Yb) радиационными дефектами. Козловский В. В., Захаренков Л. Ф. 2, 345

Электрические свойства слоистых монокристаллов $MnGaAsS_4$. Нифтиев Н. Н., Рустамов А. Г., Тагиев О. Б. 3, 386

Неомическая проводимость Ge: Sb вблизи перехода металл—изолятор. Матвеев Г. А., Лончаков А. Т. 3, 409

Взаимодействие дрейфующих электронов с оптическими фононами. Пожела Ю., Пожела К. 3, 497

Электрофизические свойства пленок $(Sn_{0.8}Ge_{0.2})_{1-x}In_xTe$, полученные методом лазерного напыления. Мусихин С. Ф., Немов С. А., Прошин В. И., Семин И. Е., Шамшур Д. В., Березин А. В. 3, 513

Динамическая проводимость компенсированного кремния при всестороннем гидростатическом сжатии. Абдураимов А., Зайнабидинов С. З., Маматкаримов О. О., Турсунов И. Г., Химматкулов О. 3, 516

Почему постоянно подвижность электронов в HgSe: Fe при низких температурах? Кулев И. Г., Леринман Н. К., Ляпилин И. И., Сабирзянова Л. Д., Цидильковский И. М. 3, 519

Геометрия образца и гальваномагнитные эффекты в полупроводниках. Ахиезер И. Т., Гуревич Ю. Г., Закиров Н. 4, 628

Эффект увеличения диффузионной длины носителей заряда в поликристаллических пленках PbTe. Дашевский З. М., Руленко М. П. 4, 662

Эффект Холла в расплавах полупроводников с вырожденным электронным газом и его взаимосвязь с электропроводностью и магнитной восприимчивостью. Глазов В. М., Кольцов В. Б. 5, 669

Дисперсионный перенос в неупорядоченных органических полупроводниках. Плюхин А. В. 4, 688

Индуклируемые током добавки к эффективной диэлектрической проницаемости неоднородных полупроводниковых сплавов. Васьюк Ф. Т., Солдатенко Ю. Н. 4, 695

Эффект Холла в расплавах полупроводников с вырожденным электронным газом и его взаимосвязь с электропроводностью и магнитной восприимчивостью. Глазов В. М., Кольцов В. Б. 5, 769

Фотомангнитный эффект n -InSb в сильном электрическом и квантующем магнитном полях. Кадушкин В. И. 5, 808

Резонансы в температурной зависимости электропроводности легированного кремния, обусловленных возбужденными состояниями примеси. Ждан А. Г., Лифшиц Т. М., Рыльков В. В., Шафран А. Г. 5, 845

Орбитальный магнитный отклик в мезоскопических проводниках. Шапиров Б. 5, 854

Детальное изучение проводимости на постоянном токе в разупорядоченных системах за счет прыжкового перемещения поларонов малого радиуса. Триберис Г. П. 5, 862

Влияние случайно распределенных доноров на динамику баллистических электронов. Санин А. Л. 5, 895

Изменение электросопротивления тензорезисторов при изгибе. Антипов С. А., Батаронов И. А., Дрожжин А. И., Рошупкин А. М. 6, 937

Нелинейная восприимчивость электронов в неоднородных полупроводниковых сплавах. Васьюк Ф. Т., Солдатенко Ю. Н. 6, 1058

Исследование чувствительности к водороду структуры ZnSe/GaAs. Маккекечко А. Ю., Коваленко А. В., Черненко И. М., Катков В. Ф. 6, 1060

Влияние этанола на электрофизические свойства диоксида олова. Андреева Е. В., Зильберман А. Б., Ильин Ю. Л., Махин А. В., Мошников В. А., Яськов Д. А. 7, 1095

Морфология, проводимость и эффект псевдолегирования в аморфных и аморфнокристаллических пленках С:Н. Данченко А. А., Лигачев В. А., Попов А. И. 8, 1233

Рекомбинационные механизмы и кинетические явления в одноосно-напряженном $Cd_xHg_{1-x}Te$. Гасан-заде С. Г., Шепельский Г. А. 8, 1326

Влияние концентрации азота на микроструктуру и темновую проводимость пленок

- α -Si_{1-x}N_x: Н. Будагян Б. Г., Айвазов А. А., Сазонов А. Ю. 8, 1365
- Изменение гальваномагнитных свойств легированного антимонида кадмия при естественном старении. Грицюк Б. Н., Раренко А. И., Сирота А. В., Халаймеда Д. Д. 9, 1541
- Исследование электрофизических свойств монокристаллов высокоомного кремния n -типа проводимости в широком интервале температур. Глазов В. М., Пильдон В. И., Зубков А. М., Кольцов В. Б. 10, 1605
- Особенности низкотемпературной проводимости германия, легированного ртутью. Банная В. Ф., Литвак-Горская Л. Б., Луговая Г. Я. 10, 1661
- Исследование влияния магнитного поля на условия возбуждения и параметры неустойчивостей тока инфранизких частот в Si(S). Бахадыханов М. К., Аскаров Ш. И., Курбанова У. Х. 10, 1684
- Влияние уровня легирования и температуры на эффект Стеблера-Вронского в пленках α -Si: Н, легированных фосфором. Казанский А. Г., Яркин Д. Г. 10, 1693
- О природе фотоиндуцированных дефектов в аморфном гидрированном кремнии. Звягин И. П., Курова И. А., Ормонт Н. Н. 10, 1707
- Электрофизические свойства теллурида висмута, легированного индием. Житинская М. К., Немов С. А., Равич Ю. И., Абайдулина Т. Г., Компанец В. В., Бушмарина Г. С., Дабкин И. А. 10, 1724
- Перколяция тока в полимерно-полупроводниковой структуре. Фиштель В. И. 11/12, 1788
- Влияние особенностей структуры эпитаксиальных слоев Cd_xHg_{1-x}Te на электрические и фотоэлектрические свойства при лазерном облучении. Мозоль П. Е., Гнатюк В. А., Сукач А. В., Власенко А. И., Копишинская Е. П., Лукьяненко В. И. 11/12, 1820
- Самокомпенсация в области собственной проводимости CdTe(Cl) в условиях двухфазного равновесия системы кристалл—газ. Матвеев О. А., Терентьев А. И. 11/12, 1894
- Явление перехода от закона Эфроса—Шкловского к закону Мотта в прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка. Шлимак И. С. 11/12, 1945
- Токовые структуры в Si(Zn). Астров Ю. А. 11/12, 1973
- Исследование структуры токовых нитей в Si(Zn). Астров Ю. А., Хорев С. А. 11/12, 2027
- 3.2.1. *Генерация, рекомбинация, время жизни носителей заряда* (PACS 72.20 N)
- Фоторефрактивный метод бесконтактного определения рекомбинационных характеристик полупроводников. Миргородский В. И., Сабликов В. А., Филатов А. Л. 1, 81
- Картирование времени жизни неравновесных носителей в кремниевых пластинах со структурой из алюминиевых полосок. Миляев
- Генерация неосновных носителей заряда в электрических полях макроскопических неоднородностей на границе раздела полупроводник—диэлектрик. Гольдман Е. И. 2, 269
- Преимущества режима переменного тока, введенного электронным лучом, для определения параметров полупроводника. Романовский А. 3, 369
- «Вспышечная» кинетика радиационного заряжения в неупорядоченных диэлектриках. Архипов В. И., Перова И. А. 4, 682
- Фотоэлектрически активные и неактивные медленные центры прилипания электронов в кристаллах ZnSe. Ризаханов М. А., Хамидов М. М. 5, 721
- Влияние примесей галогенов на перенос носителей заряда в стеклообразных полупроводниках системы Se—As. Казакова Л. П., Лебедев Э. А., Исаев А. И., Мехтиева С. И., Захарова Н. Б., Ятлинко И. И. 6, 959
- Рекомбинационные механизмы и кинетические явления в одноосно-напряженном Cd_xHg_{1-x}Te. Гасан-заде С. Г., Шепельский Г. А. 8, 1326
- Осцилляции фотопроводимости и особенности релаксационной кинетики в α -Si: Н. Будагян Б. Г., Айвазов А. А., Становов О. Н. 9, 1489
- Рекомбинация через комплексы оборванных связей в аморфном кремнии. Звягин И. П., 11/12, 1857
- Инверсная заселенность уровней пространственного квантования в двумерных системах InAs/AlSb/GaSb. Васильев Ю. Б., Сулчалкин С. Д. 11/12, 1992
- 3.2.2. *Фотопроводимость и фотовольтагический эффект* (PACS 72.40)
- Фотоэлектрические свойства пленок теллурида кадмия, подвергнутых лазерному облучению. Байдуллаева А., Даулетмуратов Б. К., Власенко А. И., Гнатюк В. А., Мозоль П. Е. 1, 56
- Особенности фотопроводимости классических сверхрешеток на основе p -Ge в инфракрасном диапазоне. Гусятников В. Н., Иванченко В. А., Николаев М. В. 1, 182
- Свойства компенсированных пленок в системе сульфид свинца—сульфид кадмия. Зимин С. П., Корегина Е. Л., Бочкарева Л. В. 1, 185
- Фотоэлектрические свойства гетеропереходов n -CdS(In)— p -CuInSe₂. Магомедов М. А., Рудь Ю. В. 2, 245
- Нелинейность фотопроводимости германия с примесями ртути, кобальта и цинка при возбуждении излучением с $\lambda = 10.6$ мкм. Асланов Г. А., Бурбаев Т. М., Курбаатов В. А., Пенин Н. А. 2, 277
- Расчет динамики фотоотклика диодов с резким переходом при высоких уровнях фотовоз-

- буждения. Кудряшов Н. А., Кучеренко С. С., Фетисов Н. В. 2, 358
- Теория фотогальванических эффектов в n -GaP. Расулов Р. Я., Сидикова Х., Ганиева У. 3, 374
- Теория фотогальванических эффектов в кристаллах со сложной зонной структурой при двухфотонном поглощении света. Расулов Р. Я., Ганиев У. У., Сидикова Х. А. 4, 635
- Увеличение фотопроводимости в магнитном поле. Викулина К. И., Ирха В. И., Шнайдер И. П. 4, 712
- Длинноволновый край явления остаточной фотопроводимости в $Pb_{0.78}Sn_{0.22}Te$ с примесью In. Воронова И. Д., Горник Е., Клышевич Е. В., Кремсер К., Чеботарев А. П. 5, 827
- Численный расчет нестационарных характеристик в вертикальных полевых фототранзисторах на основе GaAs. Абашкина С. А., Корольков В. И., Римшанс Я. С., Скрыль Ю. И., Табаров Т. С. 6, 966
- Последеградиционные характеристики $p-i-n$ фотоэлементов из гидрированного аморфного кремния (α -Si:H). Аронов Д. А., Кабулов Р. Р., Маматкулов Р., Усманов Ш., Юбов Ю. М. 6, 1014
- Исследование кинетики спада фотопроводимости в кремнии, легированном осмием. Азимов С. А., Юнусов М. С., Нуркузиев Г. 7, 1073
- Влияние рекомбинации в области пространственного заряда на люкс-вольтовые характеристики поверхностной фотоздс в GaAs и InP. Бедный Б. И., Байдуш Н. В. 7, 1125
- Анизотропия фотопроводимости в монокристаллах GeS. Алекперов О. Э., Гамзаев Д. О., Кулибеков А. М., Сулейманов Р. А. 7, 1180
- Влияние смещения на фотоотклик кремниевых структур при освещении импульсными CO_2 -лазера. Ашмонтас С., Градаускас И., Ширмулис Э. 7, 1185
- Инфракрасная фотопроводимость и люминесценция квантовых ям в многослойных гетероструктурах GaAs/AlGaAs. Горбылев В. А., Залевский И. Д., Петров А. И., Челный А. А., Аветисян Г. Х., Куликов В. Б., Чукичев В. М., Юнович А. Э. 9, 1453
- Осцилляции фотопроводимости и особенности релаксационной кинетики в α -Si:H. Будагян Б. Г., Айвазов А. А., Становов О. Н. 9, 1489
- Особенности температурных и спектральных характеристик фотопроводимости и фотоманнитного эффекта в p - $Cd_xHg_{1-x}Te$ при низких температурах. Гасан-заде С. Г., Богобаяш В. В., Жадько И. П., Зинченко Э. А., Шепельский Г. А. 9, 1508
- Особенности температурной зависимости фотопроводимости кремния, легированного золотом. Закиров А. С., Игамбердыев Х. Т., Мамадалимов А. Т., Хабибуллаев П. К. 9, 1556
- Поляризационная фоточувствительность эпитаксиальных GaP-структур на Si-подложках. Жилиев Ю. В., Назаров Н., Рудь В. Ю., Рудь Ю. В., Федоров Л. М. 10, 1611
- Оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов CdTe: Fe и $Cd_{1-x}Fe_xTe$. Гнатенко Ю. П., Фарина И. А., Гамерник Р. В., Крочук А. С., Бабий П. И. 10, 1639
- Влияние легирования на фотопроводимость α -Si: H. Казанский А. Г., Шамонова Е. А. 10, 1688
- О природе фотоиндуцированных дефектов в аморфном гидрированном кремнии. Звягин И. П., Курова И. А., Ормонт Н. Н. 10, 1707
- Индукцированная примесная фотопроводимость в кремнии, легированном серой. Туланов В. Т., Сиябеков Х. Б. 10, 1751
- Переходные процессы в $n-p$ -структурах на основе $Cd_xHg_{1-x}Te$. Андрухив М. Г., Белотелов С. В., Вирт И. С. 11/12, 1863
- 3.3. Электронная структура и электрические свойства поверхности, границ раздела и тонких пленок (PACS 73)
- Некоторые физические свойства GaSe(MeNO₂) (Me—Na, K) и биинтеркалатов на их основе. Нетяга В. В., Григорчак И. И., Ковалюк З. Д. 7, 1220
- Сверхрешетки Ge— $Ge_{1-x}Si_x$, полученные гидридным методом. Кузнецов О. А., Орлов Л. К., Дроздов Ю. Н., Воротынцева В. М., Мильвидский М. Г., Вдовин В. И., Карлес Р., Ланда Г. 10, 1591
- Влияние поверхностного потенциала на образование поверхностного фотографического изображения в AgBr. Горлин Г. Б., Туланов В. Т. 11/12, 1967
- 3.3.1. Электронные состояния на поверхности, границах раздела и в системах с пониженной размерностью (PACS 73.20)
- Прямой метод определения плотности поверхностных состояний по токам накачки заряда. Левин М. Н., Литманович В. И., Татаришвили А. В., Чернышев В. Е. 1, 3
- Влияние состава слоев на зонный спектр сверхрешеток типа $Cd_xHg_{1-x}Te$ — $Cd_yHg_{1-y}Te$. Герчиков Л. Г., Субашиев А. В., Салман Далла. 1, 60
- Осциллирующее магнитопоглощение многослойных квантово-размерных структур. Ильинская Н. Д., Кохановский С. И., Сейсян Р. П. 1, 108
- Особенности фотопроводимости классических сверхрешеток на основе p -Ge в инфракрасном диапазоне. Гусятников В. Н., Иванченко В. А., Николаев М. В. 1, 182

поглощение инфракрасного излучения дырками в структурах с квантовыми ямами. Алешкин В. Я., Романов Ю. А. 2, 329

Массы дырочных подзон размерного квантования полупроводниковых гетероструктур разной ориентации. Герчиков Л. Г., Су-башиев А. В. 3, 446

Влияние границы раздела на захват и эмиссию носителей глубокими центрами. Пахомов А. А., Ясиевич И. Н. 3, 482

Феноменологический анализ граничных условий для волновой функции модели Кейна. Кисин М. В. 3, 488

Электронные минизоны в сверхрешетках (GaAs)_N(AlAs)_M при четном и нечетном *M*. Алейнер И. Л., Ивченко Е. Л. 4, 594

Размерное квантование дырок в сложной валентной зоне во внешнем магнитном поле, параллельном поверхности. Аверкиев Н. С., Моныхов А. М. 4, 600

Исследование параметров зонной структуры в приповерхностных слоях эпитаксиальных пленок узкощелевых твердых растворов Zn_xHg_{1-x}Te. Яфясов А. М., Савицкий В. Г., Ковтун Р. Н., Перепелкин А. Д., Боженов В. Б. 5, 762

Поверхностные свойства пленок α -Si:H. Данишевский А. М., Латинис В., Коньков О. И., Теруков Е. И., Мездрогина М. М., Чусовитин М. С. 6, 913

Проводимость инверсионных слоев и температурная зависимость плотности поверхностных состояний в МДП структурах. Гергель В. А., Шпатаковская Г. В. 6, 923

Вольт-фарадные характеристики сверхрешеток. Алешкин В. Я., Звонков Б. Н., Линькова Е. Р., Мурель А. В., Романов Ю. А. 6, 931

Экситон в полупроводниковой квантовой яме и сильном магнитном поле. Кавокин А. В., Несвижский А. И., Сейсян Р. П. 6, 977

Энергетически неоднородная в пространстве функция распределения электронов в полупроводниковом субмикронном слое. Гуревич Ю. Г., Логвинов Г. Н., Титов О. Ю. 6, 1040

Модуляционные спектры структур легированных квантовых ям GaAs—Al_{0,3}Ga_{0,7}As. Кавалюкасас Ю., Кривайте Г., Шилейка А. 7, 1086

Осцилляции магнитосопротивления в напряженном сверхрешетках Ge/Ge_{1-x}Si_x в наклонном магнитном поле. Арапов Ю. Г., Городилов Н. А., Кузнецов О. А., Неверов В. Н., Орлов Л. К., Рубцова Р. А., Харус Г. И., Чернов А. Л., Шелушина Н. Г., Штрапенин Г. Л. 7, 1165

Фотолюминесценция из квантовой ямы с высокой концентрацией фотоносителей. Алешкин В. Я., Красильник З. Ф., Ревин Д. Г. 7, 1190

Спектры энергий и оптического поглощения мелких примесей в полупроводниковой квантовой точке. Галиев В. И., Полупанова А. Ф. 7, 1202

Кулоновское взаимодействие носителей в тонких полупроводниковых нитях. Андрушин Е. А., Силин А. П. 8, 1256

Влияние термообработки на параметры границы раздела структур Si—SiO₂ после радиационных воздействий. Вовк О. В., Лелеченко В. П., Солощенко В. И., Ройзин Я. О., Чукунина В. Н. 8, 1349

Приграничные электронные состояния в полупроводниковых (IV—VI) сверхрешетках. Канцер В. Г., Малкова Н. М. 10, 1585

Гетероэпитаксиальная пассивация поверхности GaAs. Карпович И. А., Бедный Б. И., Байдусь Н. В., Батукова Л. М., Звонков Б. Н., Степихова М. В. 10, 1736

Когерентное и последовательное туннелирование в резонансно-туннельном диоде со спейсером. Ларкин И. А., Ханин Ю. Н. 11/12, 1800

Сверхрешетка PbS—CdS, полученные лазерным испарением в вакууме. Бакуева Л. Г., Ильин В. И., Мусихин С. Ф., Рабизо О. В., Шаронова Л. В., Гирич А. В. 11/12, 1866

3.3.2. Контактные явления (PACS 73.30; 73.40)

Экранированное кулоновское взаимодействие и полярный экситон в МДП структуре. Берил С. И., Покатилов Е. П., Зотов А. С., Фарах М., Фай Л. К. 1, 12

Определение энергетического спектра плотности поверхностных состояний в МДП структурах с помощью емкостной спектроскопии DLTS при учете взаимодействия с неосновными носителями тока. Лебедев А. А., Экке В. 1, 76

Влияние обработки поверхности арсенида галлия в парах халькогенов на свойства барьеров Шоттки в структурах Me—GaAs. Сысоев Б. И., Безрядин Н. Н., Котов Г. И., Стрыгин В. Д. 1, 131

Особенности генерационного тока в облученных α -частицами p^+ — n -переходах из высокоомного кремния. Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. Б. 2, 205

Электронные свойства границ раздела полупроводника—диэлектрик в тонкопленочном транзисторе на основе структуры SiO₂— α -Si(H)—пленка Ленгмюра—Блоджет. Антоненко В. И., Знаменский Д. А., Каллугин С. М., Леванович В. Н., Моисеев Ю. Н., Панов В. И., Тодуа П. А., Уласюк В. Н., Юсупов Р. Г. 2, 221

Фотоэлектрические свойства гетеропереходов n -CdS(In)— p -CuInSe₂. Магомедов М. А., Рудь Ю. В. 2, 245

Влияние структурной неоднородности полупроводника и диэлектрика на зарядовые свойства поверхности МДП структур. Муминов Р. А., Малаева В. Т., Оксан М. М., Ишмуратов Г. В., Юнусова Х. 2, 250

Генерация неосновных носителей заряда в электрических полях макроскопических

- неоднородностей на границе раздела полупроводник—диэлектрик. Гольдман Е. И. 2, 269
- Обратные темновые токи в структурах полупроводник—диэлектрик—полупроводник с тонким диэлектриком. Дидейкин А. Т., Немчук Н. И. 2, 362
- Фоточувствительность поверхностно-барьерных структур на основе InP с микрорельефной границей раздела. Басюк Е. В., Дмитрук Н. Л., Маева О. И. 3, 415
- Электрическое переключение проводимости с памятью в кремниевых МДП структурах с диэлектриком из фторида эрбия. Рожков В. А., Шалимова М. Б. 3, 438
- Инверсия типа проводимости слоя арсенида цинка в гетероструктуре $\text{In}_2\text{O}_3\text{—ZnSe—}(\text{Zn}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te})_{1-y}\text{—}(\text{In}_2\text{Te}_3)_y\text{—In}$. Беляев А. П., Рубец В. П., Тошходжаев Х. А., Калинин И. П. 3, 527
- Туннельный эффект как причина тока, ограниченного контактной эмиссией в гетероструктуре $\text{In}_2\text{O}_3\text{—ZnSe—}(\text{Zn}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te})_{1-y}\text{—}(\text{In}_2\text{Te}_3)_y\text{—In}$. Беляев А. П., Рубец В. П., Тошходжаев Х. А., Калинин И. П. 3, 532
- ЭлектрOLUMИнесценция эпитаксиальных GaP $p\text{—}n$ -структур, выращенных на Si-подложках. Евстропов В. В., Жилев Ю. В., Назаров Н., Сергеев Д. В., Федоров Л. М. 4, 668
- Влияние подвижных дефектов на характеристики контакта металл—полупроводник в кристаллах CdS. Дроздова И. А., Ембергенов Б., Корсунская Н. Е., Маркевич И. В. 4, 674
- Исследование статистических вольт-амперных характеристик резонансно-туннельных диодов на основе гетероструктур GaAs/AlAs. Игнатьев А. С., Каменев А. В., Копылов В. Б., Немцов Г. З., Посвянский Д. В. 5, 775
- О механизме тока в тонкопленочных монокристаллических $p\text{—}n$ -переходах на основе PbS. Кузнецов В. С., Бочкарева Л. В. 5, 785
- Фоточувствительность гетеропереходов $n\text{—Cd}_0.8\text{Zn}_0.2\text{S—}p\text{—CuInSe}_2$. Константинова Н. Н., Магомедов М. А., Рудь Ю. В. 5, 835
- Влияние нейтронного облучения на перемещение границы $p\text{—}n$ -перехода в светодиодах на основе GaAsP(Zn). Сукач Г. А. 5, 838
- Поверхностные состояния на кремнии в МДП (металл—диэлектрик—полупроводник) структурах с туннельно-тонким слоем окисла. Берман Л. С., Грехов И. В., Каримов И. Н., Остроумова Е. В. 6, 917
- Проводимость инверсионных слоев и температурная зависимость плотности поверхностных состояний в МДП структурах. Гергель В. А., Шпатаковская Г. В. 6, 923
- Вольт-фарадные характеристики сверхрешеток. Алешкин В. Я., Звонков Б. Н., Линькова Е. Р., Мурель А. В., Романов Ю. А. 6, 931
- Ударная ионизация электронов и дырок и лавинный пробой в МТДП структурах. Дობровольский В. Н., Нинидзе Г. К., Петрусенко В. Н. 6, 944
- Спектр токового шума микроплазмы при высокоимпедансном включении диода. Ионовенков А. Н., Константинов О. В., Пирогов В. И. 6, 951
- Примесь алюминия в кремниевых полупроводниковых структурах $\text{SiO}_2\text{—Si}$. Дутов А. Г., Комар В. А., Ширяев С. В. 6, 1001
- МОП конденсатор на основе термически окисленного $p\text{—}6\text{H—SiC}$ (0001) С. Иванова П. А., Пантелеев В. Н., Самсонова Т. П., Суворов А. В., Челноков В. Е. 7, 1146
- Энергетическая диаграмма гетероперехода $\text{Pb}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te/PbTe}$. Трофимов В. Т., Аббасов Г. З., Спрингхольц Г., Бауэр Г., Засавацкий И. И. 7, 1158
- Усиление фототока в диодных структурах $\text{Pd—SiO}_2\text{—}n(p)\text{—Si}$. Слободчиков С. В., Ковалевская Г. Г., Пенцов А. В., Салихов Х. М. 7, 1213
- Тензосвойства диодов с барьером Шоттки при всестороннем гидростатическом сжатии. Абдураимов А., Зайнабидинов С. З., Маматкаримов О. О., Химматкулов О. 7, 1216
- Идентификация многозарядных объемных уровней при релаксационной спектроскопии границы раздела полупроводник—диэлектрик. Дмитриев С. Г., Ждан А. Г., Маркин Ю. В. 8, 1247
- Инверсия электрического поля у освещаемого анода МПМ диода. Резников Б. И., Царенков Г. В. 8, 1262
- Электрические свойства эпитаксиальных $p\text{—}n$ -структур из GaP на Si-подложках. Евстропов В. В., Жилев Ю. В., Назаров Н., Сергеев Д. В., Федоров Л. М., Шерняков Ю. М. 8, 1319
- Влияние нитридации на радиационное изменение электрофизических свойств МДП структур на основе кремния. Кучинский П. В., Ломако В. М., Петрунин А. П., Патракеев С. П., Суриков И. Н., Шахлевич Л. Н. 8, 1354
- Светоувствительные структуры Шоттки на пористом кремнии. Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Сресели О. М., Ярошецкий И. Д. 8, 1371
- Изотермическая и термостимулированная релаксация тока и емкости в слабо асимметричном $p\text{—}n$ -переходе с неоднородным профилем легирования n - и p -областей. Урманов Н. А., Степанова М. Н. 9, 1495
- Аномальные (с двумя максимумами) пики в спектрах токовой спектроскопии в $p\text{—}n$ -структуре, связанные с одним типом глубоких состояний. Урманов Н. А., Гафурова М. В. 9, 1535
- Влияние начального заполнения глубоких центров на положение пика термостимулированного тока в $n\text{—}p$ -переходе с произвольным отношением концентрации мелких и глу-

- боких центров. Урманов Н. А., Гафуров-ва М. В. 9, 1572
- Исследование распределения примеси в области гетерограниц p -GaInAsSb/ p -GaAlAsSb. Богословская А. Б., Колчанова Н. М., Манякин Ф. И., Попов А. А., Сукач Г. А. 9, 1574
- Эффект усиления наведенного фото-плехрохризма в структурах p - n -GaP/ p -Si. Беркелиев А., Жиляев Ю. В., Назаров Н., Рудь В. Ю., Рудь Ю. В., Федоров Л. М. 10, 1624
- Моделирование профилей распределения концентрации носителей тока в LoW—HIGH-переходах с промежуточным слоем противоположного типа легирования. Тетельбаум Д. И., Якунин Ю. И., Касаткин А. П., Мурель А. В. 10, 1657
- Фотодиодные МПМ структуры с низкой величиной плотности темнового тока. Аверин С. В., Новиков С. В., Мескида-Кюстерс А., Потапов В. Т., Хейме К., Царев А. Н., Шмарцев Ю. В. 11/12, 1811
- Переходные процессы в n - p -структурах на основе $Cd_xHg_{1-x}Te$. Андрухив М. Г., Белотелов С. В., Вирт И. С. 11/12, 1863
- Исследование пространственной стабилизации тока в системе полупроводник—газовый разряд. Парицкий Л. Г., Хайдаров З., Мухамадиев О., Дадабаев О. 11/12, 2011
- Особенности контакта полупроводник—газовый разряд при малых межэлектродных расстояниях. Парицкий Л. Г., Хайдаров З. 11/12, 2019
- Прецизионная полупроводниковая спектрометрия ионов. Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Маляренко А. М., Строкан Н. Б., Суханов В. Л., Шмидт Б., Борани И. 11/12, 2055
- 3.3.3. Электронные транспортные явления в тонких пленках и в системах с пониженной размерностью (PACS 73.50)**
- Квантовое и классическое времена релаксации и свойства гетерограницы в селективно легированных гетероструктурах InP/In_{0.53}Ga_{0.47}As. Быстров С. Д., Крещук А. М., Новиков С. В., Полянская Т. А., Савельев И. Г. 4, 645
- Влияние интеркалирования Li и Ва на электрофизические свойства InSe. Кульбачинский В. А., Ковалюк М. З., Пырля М. Н. 4, 677
- Фотомангнитный эффект и фотопроводимость тонких эпитаксиальных слоев $Cd_xHg_{1-x}Te/CdTe$. Студеникин С. А., Панаев И. А., Костюченко В. Я., Торчинов Х.-М. 3, 5, 744
- Временные характеристики одночастичного рассеяния в одномерных системах. Чуприков Н. Л. 5, 799
- Диагностика пленок арсенида галлия, выращенных методом атомнослоевой эпитаксии. Кольченко Т. И., Коява В. Т., Ломако В. М. 5, 822
- О механизме возникновения отрицательного дифференциального сопротивления в тонких пленках аморфного селена. Чеснис А. А. 5, 848
- Влияние случайно распределенных доноров на динамику баллистических электронов. Санин А. Л. 5, 895
- Проводимость инверсионных слоев и температурная зависимость плотности поверхностных состояний в МДП структурах. Гергель В. А., Шпатаковская Г. В. 6, 923
- Глубокие уровни и редукция проводимости прямой гетероструктуры с селективным легированием после подачи оптирающего импульса напряжения на затвор. Горев Н. Б., Макарова Т. В., Прохоров Е. Ф., Уколов А. Т., Эппель В. И. 6, 996
- Явления переноса в легированных сверхрешетках GaAs/Al_xGa_{1-x}As разнесенного типа. Кадушкин В. И., Шангина Е. Л. 8, 1311
- Нелинейное поведение осцилляций Шубникова—де-Гааза в сильных электрических полях в короткоканальных Al_xGa_{1-x}As/GaAs-гетероструктурах. Морозов С. В., Дубровский Ю. В. 9, 1484
- 3.4. Магнитные свойства полупроводников, магнитные резонансы (PACS 75; 76)**
- Антистоксовское преобразование излучения варизонными полупроводниками при магнитоцентрационном эффекте. Савицкий В. Г., Соколовский Б. С., Новак В. И. 1, 95
- Осциллирующее магнитопоглощение многослойных квантово-размерных структур. Ильинская Н. Д., Кохановский С. И., Сейсян Р. П. 1, 108
- Магнитоэлектрический эффект в бесщелевых полупроводниках I рода. Маргулис А. Д., Маргулис Вл. А. 2, 323
- Электрические свойства слоистых монокристаллов MnGaInS₄. Нифтиев Н. Н., Рустамов А. Г., Тагиев О. Б. 3, 386
- Параметры зонного спектра, электрофизические и магнитные свойства четверных полумангнитных полупроводников HgCdMnTe. Гавалешко Н. Н., Тетеркин В. В., Сизов Ф. Ф., Паранчич С. Ю. 3, 459
- Эффект Холла в расплавах полупроводников с вырожденным газом и его взаимосвязь с электропроводностью и магнитной восприимчивостью. Глазов В. М., Кольцов В. Б. 5, 669
- Увеличение фотопроводимости в магнитном поле. Викулина К. И., Ирха В. И., Шнайдер И. П. 4, 712
- Фотомангнитный эффект и фотопроводимость тонких эпитаксиальных слоев $Cd_xHg_{1-x}Te/CdTe$. Студеникин С. А., Панаев И. А., Костюченко В. Я., Торчинов Х.-М. 3, 5, 744

- Эффект Холла в расплавах полупроводников с вырожденным электронным газом и его взаимосвязь с электропроводностью и магнитной восприимчивостью. Глазов В. М., Кольцов Б. Б. 5, 769
- Фотомагнитный эффект n -InSb в сильном электрическом и квантующем магнитном полях. Кадушкин В. И. 5, 808
- Инверсия линии циклотронного резонанса дырок в CdSb, наблюдаемого по изменению статической проводимости. Раренко А. И., Сирота А. В., Халамейда Д. Д. 5, 851
- Орбитальный магнитный отклик в мезоскопических проводниках. Шапиро Б. 5, 854
- Экситон в полупроводниковой квантовой яме в сильном магнитном поле. Кавокина А. В., Несвижский А. И., Сейсян Р. П. 6, 977
- Магнитная восприимчивость твердых растворов $Pb_{1-x}Mn_xTe$. Лашкарев Г. В., Бродовой А. В., Мирец А. Л., Зломанов В. П., Малеванная О. И. 6, 1067
- Осцилляции магнитосопротивления в напряженных сверхрешетках $Ge/Ge_{1-x}Si_x$ в наклонном магнитном поле. Арапов Ю. Г., Городилов Н. А., Кузнецов О. А., Неверов В. Н., Орлов Л. К., Рубцова Р. А., Харус Г. И., Чернов А. Л., Шелушина Н. Г., Штрапенин Г. Л. 7, 1165
- Исследование фотомагнитных свойств пленок магнитного полупроводника $Eu_{1-x}Sm_xO$. Кабанов В. Ф., Свердлов А. М. 8, 1340
- Магнитные свойства чистых и легированных индием монокристаллов $Cd_{0.2}Hg_{0.8}Te$ при низких температурах. Лашкарев Г. В., Бродовой А. В., Мирец А. Л., Колесник С. П., Зыков Г. А., Никитин М. С. 8, 1381
- Нелинейное поведение осцилляций Шубникова—де-Гааза в сильных электрических полях в короткоканальных $Al_xGa_{1-x}/GaAs$ -гетероструктурах. Морозов С. В., Дубровский Ю. В. 9, 1484
- Оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов $CdTe:Fe$ и $Cd_{1-x}Fe_xTe$. Гнатенко Ю. П., Фарина И. А., Гамерник Р. В., Крочук А. С., Бабий П. И. 10, 1639
- Исследование влияния магнитного поля на условия возбуждения и параметры неустойчивостей тока инфранизких частот в $Si(S)$. Бахадырханов М. К., Аскаров Ш. И., Курбанова У. Х. 10, 1684
- Влияние интерференции в подложке на форму линии циклотронного поглощения двумерного электронного газа (Методическая заметка). Сучалкин С. Д., Васильев Ю. Б., Иванов Ю. Л. 11/12, 2078
- 3.5. Оптические свойства полупроводников. Взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78)**
- Влияние лазерного облучения на физические свойства высокоомных кристаллов ZnSe.
- Артамонов В. В., Байдуллаева А., Беляев С. В., Власенко А. И., Гнатюк В. А., Мозоль П. Е. 2, 228
- Фотоиндуцированные дефекты в псевдолегированном α -Si: Н. Голикова О. А., Икрамов Р. Г., Казанин М. М., Мездрогина М. М. 3, 474
- Твердофазное разложение GaAs при действии лазерного излучения пороговой плотности. Дмитриев А. Г. 4, 583
- Распределение концентрации ртути при импульсном лазерном отжиге $Cd_xHg_{1-x}Te$. Валь А., Кузьма М., Поцяк М., Шерегий Е. М. 4, 622
- Аннигиляция позитрона на примесях с глубокими уровнями в полупроводниках. Проккопьев Е. П. 9, 1569
- Механизмы образования нарушенного слоя в p -CdTe под действием лазерных импульсов наносекундной длительности. Бабенцов В. Н., Байдуллаева А., Власенко А. И., Горбань С. И., Даулетмуратов Б. К., Мозоль П. Е. 10, 1618
- Поглощение электромагнитного излучения 54—78 ГГц слаболегированным p -германием. Шеховцов Н. А. 10, 1720
- Пространственная модуляция неквадратичного закона дисперсии носителей заряда внешним высокочастотным полем в полупроводниках. Басс Ф. Г., Евтушенко О. М., Панчева А. П. 10, 1747
- Влияние особенностей структуры эпитаксиальных слоев $Cd_xHg_{1-x}Te$ на электрические и фотоэлектрические свойства при лазерном облучении. Мозоль П. Е., Гнатюк В. А., Сукач А. В., Власенко А. И., Копишинская Е. П., Лукьяненко В. И. 11/12, 1820
- Формирование энергетического спектра монолинии рентгеновского излучения при неоднородном поглощении в полупроводниковых детекторах. Иваницкая О. И., Матвеев О. А., Томасов А. А., Яковлев Н. В. 11/12, 1885
- Субмиллиметровая спектроскопия объемных полупроводников и полупроводниковых структур с пониженной размерностью с помощью плавно перестраиваемого германиевого циклотронного лазера. Иванов Ю. Л., Васильев Ю. Б., Сучалкин С. Д. 11/12, 1997
- 3.5.1. Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20)**
- Фоторефрактивный метод бесконтактного определения рекомбинационных характеристик полупроводников. Миргородский В. И., Сабликов В. А., Филатов А. Л. 1, 81
- Антистоксовское преобразование излучения варизонными полупроводниками при магнито-концентрационном эффекте. Савицкий В. Г., Соколовский Б. С., Новак В. И. 1, 95
- О перегретой оптической нестабильности в дырочных полупроводниках. Малевич В. Л. 1, 176

- Нелинейные преобразования сигнала модуляции света при квадратичной рекомбинации в фотоприемнике. Малышев В. А., Сапелкин С. В., Червяков Г. Г., Юхимец Е. А. 1, 179
- Изменение диаграммы рассеяния света монокристаллами нелегированного GaAs вследствие электронного облучения. Калинушкин В. П., Юрьев В. А. 1, 188
- Механизм оптической нелинейности в волноводных $p-i-n$ -структурах при электропоглощении света. Бутусов Д. М., Кудряшов Н. А., Кучеренко С. С., Рывкин Б. С. 2, 214
- Влияние нейтронного облучения на инфракрасное поглощение в стеклообразном трисульфиде мышьяка. Конорова Л. Ф., Жданович Н. С. 3, 470
- Влияние процесса газофазной эпитаксии дефектов в подложках из GaAs (Cr). Калинушкин В. П., Юрьев В. А., Мурин Д. И., Плоппа М. Г., Тимо Т. В. 3, 538
- Процессы формирования «новых доноров» при термообработке кремния с различной концентрацией кислорода. Андреев Б. А., Голубев В. Г., Емцев В. В., Кропотов Г. И., Оганесян Г. А., Шмальц К. 4, 567
- Поглощение инфракрасного излучения электронной плазмой при рассеянии на примесях и плазмон-фононных возбуждениях в полупроводниках. Ключанов А. А., Балмуш Н. И. 4, 655
- Индукцируемые током добавки к эффективной диэлектрической проницаемости неоднородных полупроводниковых сплавов. Васюко Ф. Т., Солдатенко Ю. Н. 4, 695
- Энергетический спектр $PbTe(Zn^{2+})$ по данным оптического поглощения. Вейс А. Н., Рыданов А. Ю., Суворова Н. А. 4, 701
- Фотовозбуждение мелких акцепторов в $Cd_xHg_{1-x}Te$. Цыпишка Д. И., Иванов-Омский В. И., Георгицэ Е. И., Гуцуляк Л. М., Миронов К. Е. 4, 714
- Фотоотражение арсенида галлия. Пихтин А. Н., Тодоров М. Т. 7, 1139
- Оптические константы лазерноосажденных пленок $CuGaSe_2$ вблизи фундаментального края поглощения. Киндяк В. В., Киндяк А. С., Гремянок В. Ф., Боднарь И. В., Рудь Ю. В., Медведкин Г. А. 7, 1154
- Исследование влияния освещения на свойства парамагнитных дефектов в пленках аморфного гидрогенизированного карбида кремния переменного состава. Карягин С. Н., Константинова Е. А., Лупачева А. Н., 7, 1227
- Двухфотонное поглощение пикосекундных лазерных импульсов в слоистом GeS . Кулибеков А., Фишер Р., Аллахвердиев К., Хаарер Д. 7, 1229
- Междолинное излучение горячих дырок в Ge и неравновесные фононы. Амиров Р. Х., Гавриленко В. И. 8, 1297
- Оптические свойства твердых растворов $CdGa_2S_4xSe_4(1-x)$. Керимова Т. Г., Гусейнов Д. Т., Гулиев Р. А., Мамедова И. А., Бабаев Т. Р. 8, 1398
- Особенности температурных и спектральных характеристик фотопроводимости и фотоманнитного эффекта в $p-Cd_xHg_{1-x}Te$ при низких температурах. Гасан-заде С. Г., Богобожий В. В., Жадько И. П., Зинченко Э. А., Шепельский Г. А. 9, 1508
- Поляризационная фоточувствительность эпитаксиальных GaP-структур на Si-подложках. Жилев Ю. В., Назаров Н., Рудь В. Ю., Рудь Ю. В., Федоров Л. М. 10, 1611
- Эффект усиления наведенного фотоглюхромизма в структурах $p-n-GaP/p-Si$. Беркелиев А., Жилаев Ю. В., Назаров Н., Рудь В. Ю., Рудь Ю. В., Федоров Л. М. 10, 1624
- Магнитофононный резонанс и инфракрасное решеточное отражение в $p-ZnSb$. Смирнов Д. В., Машовец Д. В., Сафончик М. О., Рознован Ю. В., Леотен Ж., Кнапп В. 10, 1631
- Оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов $CdTe:Fe$ и $Cd_{1-x}Fe_xTe$. Гнатченко Ю. П., Фарина И. А., Гамерник Р. В., Крочук А. С., Бабий П. И. 10, 1639

3.5.2. Комбинационное рассеяние (PACS 78.30)

- Давыдовские мультиплеты колебательных спектров и эффективные ионные заряды в кристаллах $TlInS_2$, $TlGaSe_2$. Сырбу Н. Н., Нойманн Х., Соботта Х., Риеде В. 1, 41
- Поглощение инфракрасного излучения электронной плазмой при рассеянии на примесях и плазмон-фононных возбуждениях в полупроводниках. Ключанов А. А., Балмуш Н. И. 4, 655
- Комбинационное рассеяние и люминесценция пористого кремния. Решина И. И., Гук Е. Г. 5, 728
- Диагностика пленок арсенида галлия, выращенных методом атомнослоевой эпитаксии. Кольченко Т. И., Коява В. Т., Ломаков В. М. 5, 822
- Магнитофононный резонанс и инфракрасное решеточное отражение в $p-ZnSb$. Смирнов Д. В., Машовец Д. В., Сафончик М. О., Рознован Ю. В., Леотен Ж., Кнапп В. 10, 1631

3.5.3. Фотолюминесценция, излучательная рекомбинация (PACS 78.55; 78.60)

- Краевое излучение в ZnSe (Li), облученном электронами. Гринев В. И. 1, 124
- Время-разрешенная фотолюминесценция пористого кремния. Андрианов А. В., Ковалев Д. И., Шуман В. Б., Ярощечкий И. Д. 1, 136

- структурные дефекты и фотолуминесценция эпитаксиальных слоев $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$. Семанова Г. Н., Кладько В. П., Крыштаб Т. Г., Садофьев Ю. Г., Свительский А. В., Корытцев С. В. 1, 162
- Барическая зависимость люминесценции гетероструктур $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}/\text{CdTe}$. Болгов С. С., Кислый В. П., Малютенко В. К., Савченко А. П. 1, 171
- Люминесцентное исследование долговременной кинетики носителей в эпитаксиальном арсениде галлия. Акимов А. В., Криволапчук В. В., Полетаев Н. К., Шофман В. Г. 2, 310
- Преобразование системы дефектов вблизи поверхности кристаллов CdTe , $\text{Zn}_x\text{Cd}_{1-x}\text{Te}$, $\text{CdTe}_{1-x}\text{Se}_x$, обработанных ионами аргона. Бабенков В. Н., Бекетов Г. В., Горбань С. И. 3, 504
- Деполаризация фотолуминесценции при испускании оптических фононов горячими электронами в квантовых ямах. Портной М. Е. 3, 523
- Влияние радиационного облучения на люминесценцию кристаллов CdP_2 . Федотов В. Г., Гатальский Г. В., Трухан В. М. 4, 551
- О природе индуцируемых радиационно-термическим воздействием центров люминесценции в $p\text{-GaAs}$ (Zn). Винник Е. В., Глинчук К. Д., Гуров В. И., Прохорович А. В. 4, 610
- Излучательная рекомбинация на гетеропереходе $n\text{-GaInAsSb}/n\text{-GaSb}$. Бреслер М. С., Гусев О. Б., Титков А. Н., Чебан В. Н., Яковлев Ю. П., Гулицу Э., Освальд И., Панграц И., Шимечек Т. 4, 615
- Температурная зависимость фотолуминесценции модифицированных кристаллов $\text{InP}(\text{Sn})$. Джумамахамбетов Н. Г., Дмитриев А. Г. 4, 641
- Электролюминесценция эпитаксиальных GaP $p\text{-}n$ -структур, выращенных на Si -подложках. Евстропов В. В., Жиляев Ю. В., Назаров Н., Сергеев Д. В., Федоров Л. М. 4, 668
- Комбинационное рассеяние и люминесценция пористого кремния. Решина И. И., Гук Е. Г. 5, 728
- Люминесценция поляритонов вблизи поверхности в арсениде галлия. Бойко С. И., Горбань И. С., Крохмаль А. П., Осинский В. И., Рожко И. А. 5, 815
- О механизме радиационно-стимулированных изменений положения максимума полос «примесной» люминесценции в арсениде галлия и фосфиде индия. Винник Е. В., Глинчук К. Д., Гуров В. И., Прохорович А. В. 5, 841
- Физические свойства и фотолуминесценция пористого кремния. Бреслер М. С., Яссиевич И. Н. 5, 871
- Энергетическая зависимость параметров поляризации горячей фотолуминесценции в структурах с квантовыми ямами. Мирлин Д. Н., Сапега В. Ф., Сиренко А. А., Кардона М., Плоог К. 6, 990
- О причинах различия дозовых зависимостей интенсивности различных полос люминесценции в облученных быстрыми частицами полупроводниковых соединениях $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$. Винник Е. В., Глинчук К. Д., Гуров В. И., Прохорович А. В. 6, 1030
- Экситонная фотолуминесценция приповерхностных квантовых ям в системе $\text{GaAs}/\text{AlGaAs}$. Астратов В. Н., Власов Ю. А. 7, 1101
- Исследование спектров фотолуминесценции пластически деформированных кристаллов ZnS . Берлов П. А., Буланый М. Ф., Коваленко А. В. 7, 1121
- Фотолуминесценция вырожденного электронного газа в слоях $\text{GaAs}:\text{Si}$, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Абрамов А. П., Абрамова И. Н., Вербин С. Ю., Герловин И. Я., Григорьев С. Р., Игнатьев И. В., Каримов О. З., Новиков А. Б., Новиков Б. В. 7, 1175
- Фотолуминесценция из квантовой ямы с высокой концентрацией фотоносителей. Алешкин В. Я., Красильник З. Ф., Ревин Д. Г. 7, 1190
- Структура центров свечения в кристаллах ZnSe . Ембергенов Б., Корсунская Н. Е., Рыжиков В. Д., Гальчицкий Л. П., Лисецкая Е. К. 8, 1240
- О зависимости радиационной стойкости интенсивности люминесценции твердых растворов соединений $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$ от их состава. Глинчук К. Д., Гуров В. И., Прохорович А. В. 8, 1395
- Инфракрасная фотопроводимость и люминесценция квантовых ям в многослойных гетероструктурах $\text{GaAs}/\text{AlGaAs}$. Горбылев В. А., Залевский И. Д., Петров А. И., Чельный А. А., Аветисян Г. Х., Куликов В. Б., Чукичев В. М., Юнович А. Э. 9, 1453
- Влияние легирования гадолинием висмутового раствора-расплава на остаточные примеси в эпитаксиальном GaAs . Журавлев К. С., Якушева Н. А., Шамирзаев Т. С., Погадаев В. Г., Шегай О. А. 9, 1473
- Светочувствительные структуры Шоттки на пористом кремнии. Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Сресели О. М., Ярощевский И. Д. 8, 1371
- Исследование комплекса $\text{V}_{\text{Ga}}\text{Sn}_{\text{Ga}}$ в GaAs методами поляризованной фотолуминесценции и пьезоспектроскопии. I. Строение комплекса и его переориентация при низких одноосных давлениях. Гуткин А. А., Решиков М. А., Сосновский В. Р. 9, 1516
- Исследование комплекса $\text{V}_{\text{Ga}}\text{Sn}_{\text{Ga}}$ в GaAs методами поляризованной фотолуминесценции и пьезоспектроскопии. II. Явление двухступенчатого выстраивания. Гуткин А. А., Решиков М. А., Сосновский В. Р. 9, 1526
- Бистабильность туннельного тока и фотолуминесценция в трехбарьерной структуре. Ивченко Е. Л., Киселев А. А., Зу Н., Вилландер М. 9, 1561

- Влияние галлия на спектры низкотемпературной фотолюминесценции теллурида кадмия при диффузионном легировании. Бабенцов В. Н., Власенко А. И., Сочинский Н. В., Тарбаев Н. И. 10, 1599
- Эффективная электрOLUMИНЕСЦЕНЦИЯ пористого кремния. Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Сресели О. М., Ярошецкий И. Д. 11/12, 1815
- Температурная зависимость стационарной фотолюминесценции пористого кремния в видимой области спектра. Лебедев А. А., Ременюк А. Д., Рудь Ю. В. 11/12, 1846
- Воздействие свободных электронов на динамику экситонов в QW -структурах. Ашкинадзе Б. М., Коэн Е., Рон Арза, Пфайффер Л. 11/12, 1953
- Возгорание горячей люминесценции квантовых ям в сильном магнитном поле. Иванов Ю. Л., Чураков Г. В., Кольев П. С., Устинов В. М., Егоров А. Ю., Жуков А. Е. 11/12, 2080
- 3.5.4. *Оптические свойства поверхности, границ раздела, тонких пленок (PACS 78.65)*
- Механизм оптической нелинейности в волноводных $p-i-n$ -структурах при электропоглощении света. Бутусов Д. М., Кудряшов Н. А., Кучеренко С. С., Рывкин Б. С. 2, 214
- Поглощение инфракрасного излучения дырками в структурах с квантовыми ямами. Алешкин В. Я., Романов Ю. А. 2, 329
- Деполаризация фотолюминесценции при испускании оптических фононов горячими электронами в квантовых ямах. Портной М. Е. 3, 523
- Излучательная рекомбинация на гетеропереходе II-типа $n\text{-GaInAsSb}/N\text{-GaSb}$. Бреслер М. С., Гусев О. Б., Титков А. Н., Чебан В. Н., Яковлев Ю. П., Гулицус Э., Освольд И., Панграц И., Шимечек Т. 4, 615
- Поляриметрический эффект в $\text{GaP}_x\text{As}_{1-x}$ поверхностно-барьерных структурах. Конников С. Г., Мелебаев Д., Рудь Ю. В. 5, 757
- Диагностика пленок арсенида галлия, выращенных методом атомнослоевой эпитаксии. Кольченко Т. И., Коява В. Т., Ломако В. В. 5, 822
- Фоточувствительность гетеропереходов $n\text{-Cd}_{0.8}\text{Zn}_{0.2}\text{S}-p\text{-CuInSe}_2$. Константинова Н. Н., Магомедов М. А., Рудь Ю. В. 5, 835
- Энергетическая зависимость параметров поляризации горячей фотолюминесценции в структурах с квантовыми ямами. Мирлин Д. Н., Сапега В. Ф., Сиренко А. А., Кардона М., Пльоог К. 6, 990
- Межуровневые оптические переходы в квантовых ямах. Петров А. Г., Шик А. Я. 6, 1047
- Модуляционные спектры структур легированных квантовых ям $\text{GaAs}-\text{Al}_{0.3}\text{Ga}_{0.7}\text{As}$. Кавалаяускас Ю., Кривайте Г., Шилейка А. 7, 1086.
- Экситонная фотолюминесценция приповерхностных квантовых ям в системе $\text{GaAs}/\text{AlGaAs}$. Астратов В. Н., Власов Ю. А. 7, 1101
- Влияние рекомбинации в области пространственного заряда на люкс-вольтовые характеристики поверхностной фотоздс в GaAs и InP . Бедный Б. И., Байдусь Н. В. 7, 1125
- Спектры энергий и оптического поглощения мелких примесей в полупроводниковой квантовой точке. Галиев В. И., Полупанова А. Ф. 7, 1202
- Поляризационная зависимость межзонного оптического поглощения квантовой ямы InGaAs в GaAs . Алешкин В. Я., Аншон А. В., Карпович И. А. 8, 1344
- Инфракрасная фотопроводимость и люминесценция квантовых ям в многослойных гетероструктурах $\text{GaAs}/\text{AlGaAs}$. Горбылев В. А., Залевский И. Д., Петров А. И., Чельный А. А., Аветисян Г. Х., Куликов В. Б., Чукичев В. М., Юнович А. Э. 9, 1453
- Эллипсометрическое исследование анодного окисла на твердых растворах $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$. Макарова Т. Л., Шаронова Л. В., Шмарцев Ю. В. 11/12, 1830
- Воздействие свободных электронов на динамику экситонов в QW -структурах. Ашкинадзе Б. М., Коэн Е., Рон Арза, Пфайффер Л. 11/12, 1953
- Влияние поверхностного потенциала на образование поверхностного фотографического изображения в AgBr . Горлин Г. Б., Туланов В. Т. 11/12, 1967
- Влияние интерференции в подложке на форму линии циклотронного поглощения двумерного электронного газа. (Методическая заметка). Сучалкин С. Д., Васильев Ю. Б., Иванов Ю. Л. 11/12, 2078
- Возгорание горячей люминесценции квантовых ям в сильном магнитном поле. Иванов Ю. Л., Чураков Г. В., Кольев П. С., Устинов В. М., Егоров А. Ю., Жуков А. Е. 11/12, 2080
- 3.6. *Эмиссия электронов и ионов. Ударная ионизация. Туннелирование (PACS 79)*
- Исследование статистических вольт-амперных характеристик резонансно-туннельных диодов на основе гетероструктур GaAs/AlAs . Игнатьев А. С., Каменев А. В., Копылов В. Б., Немцев Г. З., Посвянский Д. В. 5, 775
- Временные характеристики одночастичного рассеяния в одномерных системах. Чуприков Н. Л. 5, 799
- Ударная ионизация электронов и дырок и лавинный пробой в МГДП структурах. Добровольский В. Н., Нинидзе Г. К., Петрусенко В. Н. 6, 944
- Фотоионизация иона Fe^{2+} в ZnS : релаксация решетки. Васильев А. В., Зин-

- Гер Г. М., Розенфельд Ю. Б., Рыс-кин А. И. 8, 1305
- Стабильность туннельного тока и фотолюминесценции в трехбарьерной структуре. Ивченко Е. Л., Киселев А. А., Зу Н., Вилландер М. 9, 1561
- Исследование незаполненных электронных состояний и определение сродства к электрону PbS (100) с помощью спектроскопии обратной фотомиссии. Артамонов О. М., Дмитриева О. Г., Самарин С. Н., Яковлев И. И. 10, 1730
- Когерентное и последовательное туннелирование в резонансно-туннельном диоде со спейсером. Ларкин И. А., Ханин Ю. Н. 11/12, 1800
- Исследование пространственной стабилизации тока в системе полупроводник—газовый разряд. Парицкий Л. Г., Хайдаров З., Мухамадиев О., Дадабаев О. 11/12, 2011
- Особенности контакта полупроводник—газовый разряд при малых межэлектродных расстояниях. Парицкий Л. Г., Хайдаров З. 11/12, 2019
- #### 4. Получение и применение полупроводников (PACS 80)
- ##### 4.1. Методы получения, термообработка и травление полупроводников (PACS 81)
- Влияние обработки поверхности арсенида галлия в парах халькогенов на свойства барьеров Шоттки в структурах Me—GaAs. Сысоев Б. И., Безрядин Н. Н., Котов Г. И., Стрыгин В. Д. 1, 131
- Инверсия типа проводимости слоев $Cd_xHg_{1-x}Te$, подвергнутых плазменной обработке. Двуреченский А. В., Ремесник В. Г., Рязанцев И. А., Талипов Н. Х. 1, 168
- О механизме подавления генерации термононоров в кремнии примесными атомами углерода. Мурын Л. И., Маркевич В. П. 2, 193
- Получение и свойства поликристаллических твердых растворов SiC—AlN. Сафаралиев Г. К., Таиров Ю. М., Цветков В. Ф., Шабанов Ш. Ш., Пашук Е. Г., Офицерова Н. В., Авров Д. Д., Садыков С. А. 3, 402
- Свойства эпитаксиального арсенида индия, легированного редкоземельными элементами. Баранов А. Н., Воронина Т. И., Лагунова Т. С., Сиповская М. А., Шерстнев В. В., Яковлев Ю. П. 3, 421
- Электрофизические свойства пленок $(Sn_{0.8}Ge_{0.2})_{1-x}In_xTe$, полученные методом лазерного напыления. Мусихин С. Ф., Немов С. А., Прошин В. И., Семин И. Е., Шамшур Д. В., Березин А. В., Имамкулиев С. Д. 3, 513
- Влияние процесса газофазной эпитаксии дефектов в подложках из GaAs (Cr). Калинин В. П., Юрьев В. А., Мурын Д. И., Плоппа М. Г., Тимов Т. В. 3, 538
- Влияние постимплантационного отжига на электрофизические свойства слоев кремния, имплантированного фтором. Омельяновская Н. М., Краснобаев Л. Я., Федоров В. В. 4, 554
- Процессы формирования «новых доноров» при термообработке кремния с различной концентрацией кислорода. Андреев Б. А., Голубев В. Г., Емцев В. В., Кропоткин В. Г. И., Оганесян Г. А., Шмальц К. 4, 567
- Твердофазное разложение GaAs при действии лазерного излучения пороговой плотности. Дмитриев А. Г. 4, 583
- Температурная зависимость фотолюминесценции модифицированных кристаллов InP(Sn). Джумамухамбетов Н. Г., Дмитриев А. Г. 4, 641
- Легирование эпитаксиальных слоев GaAs акцепторной примесью при жидкофазной эпитаксии из растворов—расплавов Ga—Bi. Ле Туан, Новиков С. В., Савельев И. Г., Шелковников Д. Н., Шмарцев Ю. В. 6, 1007
- Расчет температурных полей в монокристаллах GaAs, выращиваемых в тонком слое расплава методом Киропулоса с жидкостной герметизацией. Ковтун Г. П., Кравченко А. И., Жуков А. И., Стерлев А. Н., Щербань А. П. 6, 1025
- Получение $p-n$ -переходов на CdTe(In) лазерным отжигом. Цюцюра Д. И., Шкумбатов П. С. 6, 1064
- Оценка температуры структурного превращения при нагреве монокристаллов кремния на основе статистической теории растворов и метода псевдопотенциала. Глазов В. М., Кольцов В. Б., Куцова В. З., Регель А. Р., Сиротюк С. В., Таран Ю. Н., Фалькевич Э. С. 7, 1080
- Влияние этанола на электрофизические свойства диоксида олова. Андреева Е. В., Зильберман А. Б., Ильин Ю. Л., Махин А. В., Мошников В. А., Яськов Д. А. 7, 1095
- Локальное геттерирование железа слоем металла, напыленного на поверхность кремния. Абдурахманов К. П., Далиев Х. С., Куликов Г. С., Лебедев А. А., Утамуралова Ш. Б., Юсупов Ш. А. 7, 1222
- Влияние термообработки на параметры границы раздела структур Si—SiO₂ после радиационных воздействий. Вовк О. В., Лелеченко В. П., Солошенко В. И., Ройзин Я. О., Чкунина В. Н. 8, 1349
- Влияние легирования гадолинием висмутового раствора—расплава на остаточные примеси в эпитаксиальном GaAs. Журавлев К. С., Якушева Н. А., Шамирзаев Т. С., Погадаев В. Г., Шегай О. А. 9, 1473
- Образование двойных термононоров в Cz—Si с различной концентрацией кислорода. Емцев В. В., Машовец Т. В., Оганесян Г. А., Шмальц К. 9, 1545

- Критическая концентрация оксида в Cz-Si и кластеризация примесных атомов при термообработке. Емцев В. В., Оганесян Г. А., Шмальц К. 9, 1549
- Сверхрешетки $\text{Ge-Ge}_{1-x}\text{Si}_x$, полученные гидридным методом. Кузнецов О. А., Орлов Л. К., Дроздов Ю. Н., Воротынцева В. М., Мильвидский М. Г., Вдовин В. И., Карлес Р., Ланда Г. 10, 1591
- Механизмы образования нарушенного слоя в $p\text{-CdTe}$ под действием лазерных импульсов наносекундной длительности. Бабенцов В. Н., Байдуллаева А., Власенко А. И., Горбань С. И., Даулетмуратов Б. К., Мозоль П. Е. 10, 1618
- Эффективность образования радиационных дефектов в p -кремнии, выращенном с использованием магнитного поля. Казакевич Л. А., Колковский И. И., Кузнецов В. И., Лугаков П. Ф., Салманов А. Р. 10, 1680
- Перколяция тока в полимерно-полупроводниковой структуре. Фистуль В. И. 11/12, 1788
- Кинетика образования структурных дефектов в поверхностном слое кремния при термическом окислении. Шаповалов В. П., Грядун В. И., Токарев В. П. 11/12, 1851
- Сверхрешетки PbS-CdS , полученные лазерным испарением в вакууме. Бакуева Л. Г., Ильин В. И., Мусихин С. Ф., Рабизо О. В., Шаронова Л. В., Гирич А. В. 11/12, 1866
- Алмазоподобные пленки, полученные лазерным напылением, и многослойные структуры на их основе. Бакуева Л. Г., Ильин В. И., Мусихин С. Ф., Шаронова Л. В. 11/12, 1868
- Роль света в процессах формирования пористого кремния на подложках p -типа. Беляков Л. В., Горячев Д. Н., Сресели О. М., Ярошецкий И. Д. 11/12, 1963
- «Новые доноры» в термообработанном кремнии с изoeлектронной примесью германия. Емцев В. В., Оганесян Г. А., Шмальц К. 11/12, 2024
- 4.2. Применение полупроводников, полупроводниковые приборы (PACS 85)
- Статические характеристики кремниевого оже-транзистора с туннельным МОП эмиттером и индуцированной базой. Грехов И. В., Шулекин А. Ф., Векслер М. И. 1, 88
- Экспериментальный полевой транзистор на основе карбида кремния политипа 4H. Аникин М. М., Иванов П. А., Растегаев В. П., Савкина Н. С., Сыркин А. Л., Челноков В. Е. 1, 102
- (AlGaAs/GaAs) фотоприемники на подложках Si, полученные комбинированным методом жидкофазной и молекулярно-пучковой эпитаксии. Андреев В. М., Антипов В. Г., Калиновский В. С., Каллион Р. В., Никишин С. А., Рувимов С. С., Степанов М. В., Танклевская Е. М., Хвостиков В. П. 1, 141
- Спектральные и электрические характеристики гетероструктур $n\text{-GaAs-(n-p)-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As-p-Al}(\gamma > x)\text{Ga}_{1-y}\text{As-p}^+\text{-GaAs}$ с ультратонкими поверхностными слоями. Андреев В. М., Калиновский В. С., Миланова М. М., Минтаиров А. М., Румянцев В. Д., Смекалин К. Е., Стругова Е. О. 1, 156
- Нелинейные преобразования сигнала модуляции света при квадратичной рекомбинации в фотоприемнике. Малышев В. А., Сапелкин С. В., Червяков Г. Г., Юхимец Е. А. 1, 179
- Особенности генерационного тока в облученных α -частицами p^+n -переходах из высокоомного кремния. Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. Б. 2, 205
- Электронные свойства границ раздела полупроводник-диэлектрик в тонкопленочном транзисторе на основе структуры $\text{SiO}_2\text{-a-Si(H)}$ -пленка Ленгмюра-Блуджет. Антоненко В. И., Знаменский Д. А., Калугин С. М., Леванович В. Н., Моисеев Ю. Н., Панов В. И., Тодуа П. А., Уласюк В. Н., Юсупов Р. Г. 2, 221
- Расчет динамики фототоклика диодов с резким переходом при высоких уровнях фотовозбуждения. Кудряшов Н. А., Кучеренко С. С., Фетисов Н. В. 2, 358
- Фоточувствительность поверхностно-барьерных структур на основе InP с микрорельефной границей раздела. Басюк Е. В., Дмитрук Н. Л., Маева О. И. 3, 415
- Изменение электросопротивления тензорезисторов при изгибе. Антипов С. А., Батаронов И. А., Дрожжин А. И., Рощупкин А. М. 6, 937
- Численный расчет нестационарных характеристик в вертикальных полевых фототранзисторах на основе GaAs. Абашкина С. А., Корольков В. И., Римшанс Я. С., Скраль Ю. И., Табаров Т. С. 6, 966
- Последеградационные характеристики $p-i-n$ фотоземленов из гидрированного аморфного кремния (a-Si:H). Аронов Д. А., Кабулов Р. Р., Маматкулов Р., Усманов Ш., Юабов Ю. М. 6, 1014
- Радиационное воздействие дейтронов на приемники излучения из высокоомного кремния. Вербицкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Строкан Н. Б. 7, 1113
- МОП конденсатор на основе термически окисленного $n\text{-6H-SiC}$ (0001) С. Иванова П. А., Пантелеев В. Н., Самсонова Т. П., Суворов А. В., Челноков В. Е. 7, 1146
- Усиление фототока в диодных структурах $\text{Pd-SiO}_2\text{-n(p)-Si}$. Слободчиков С. В., Ковалевская Г. Г., Пенцов А. В., Салихов Х. М. 7, 1213

Гензосвойства диодов с барьером Шоттки при всестороннем гидростатическом сжатии. Абдураимов А., Зайнабидинов С. З., Маматкаримов О. О., Химматкулов О. 7, 1216

Детекторы ионизирующего излучения на структуре скнтилирующего (подложка)—планарный фотоприемник $ZnSe_xTe_{1-x}ZnSe$. Коваленко А. В., Бочкова Т. М. 8, 1355

О роли H_2^+ -комплексов в оптимизации n -InSb-смешестительной миллиметрового диапазона волн. Гершензон Е. М., Грачев С. А., Литвак-Горская Л. Б. 9, 1464

Исследование влияния магнитного поля на условия возбуждения и параметры неустойчивости тока инфранизких частот в Si (S). Бахадырханов М. К., Аскарров Ш. И., Курбанова У. Х. 10, 1684

Особенности зависимости от тока эффективности спонтанного излучения лазерных диодов с одиночной квантовой ямой на AlGaAs/GaAs. Гарбузов Д. З., Гулаков А. Б., Кочнев И. В., Шерняков Ю. М., Халфин В. Б., Явич Б. С. 10, 1713

Фотодиоды МПМ структуры с низкой величиной плотности темнового тока. Аверин С. В., Новиков С. В., Мескида-Кюстерс А., Потапов В. Т., Хейме К., Царев А. Н., Шмарцев Ю. В. 11/12, 1811

Исследование CdTe-детекторов для вычислительной рентгеновской томографии. Карпенко В. П., Матвеев О. А. 11/12, 1904

Новые типы солнечных элементов на основе структур с переменной шириной запрещенной зоны. Ребане Ю. Т., Шретер Ю. Г. 11/12, 1925

Субмиллиметровая спектроскопия объемных полупроводников и полупроводниковых структур с пониженной размерностью с помощью плавно перестраиваемого германиевого циклотронного лазера. Иванов Ю. Л., Васильев Ю. Б., Сулчалкин С. Д. 11/12, 1997

4.3. Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55)

Длинноволновые низкорогоговые лазеры на основе соединений $A^{III}B^V$. Айдар-

алиев М., Зотова Н. В., Карандашев С. А., Матвеев Б. А., Стусь Н. М., Талалакин Г. Н. 1, 21

Безынжекционный узкополосный лазер дальнего ИК диапазона на горячих дырках и его использование для исследования примесного пробоя. Воробьев Л. Е., Данилов С. Н., Донецкий Д. В., Кочегаров Ю. В., Стафеев В. И., Фирсов Д. А. 1, 146

Особенности зависимости от тока эффективности спонтанного излучения лазерных диодов с одиночной квантовой ямой на AlGaAs/GaAs. Гарбузов Д. З., Гулаков А. Б., Кочнев И. В., Шерняков Ю. М., Халфин В. Б., Явич Б. С. 10, 1713

Инверсная заселенность уровней пространственного квантования в двумерных системах InAs—AlSb/GaSb. Васильев Ю. Б., Сулчалкин С. Д. 11/12, 1992

Субмиллиметровая спектроскопия объемных полупроводников и полупроводниковых структур с пониженной размерностью с помощью плавно перестраиваемого германиевого циклотронного лазера. Иванов Ю. Л., Васильев Ю. Б., Сулчалкин С. Д. 11/12, 1997

5. Персоналии

Памяти Шмарцева Юрия Васильевича. 3, 366
Памяти Наследова Дмитрия Николаевича. 11/12, 1761

Памяти Рывкина Соломона Мееровича. 11/12, 1871

6. Информация о новых книгах

Рецензия на книгу Ли К. и др. «Моделирование полупроводниковых приборов для Сверхбольших Интегральных Схем (СБИС)». Левинштейн М. Е. 3, 542

Рецензия на книгу Таубкина И. И., Залетаева Н. Б., Кочерова В. Ф. «Физические явления в монокристаллических примесных фоторезисторах». М. (1992). Стафеев В. И. 10, 1752